

DRV816x 保護機能および電流センス アンプ搭載、100V ハーフブリッジスマートゲートドライバ

1 特長

- ハーフブリッジ構成の 2 つの N チャンネル MOSFET を駆動
 - ハイサイド MOSFET ソース/ドレイン最大 102V (絶対最大定格)
 - 8V (5V DRV8162L)~20V のゲートドライブ電源
 - ブートストラップ ダイオードを内蔵
- 機能安全品質管理
 - 機能安全システム設計に役立つ資料を利用可能
- 内蔵トリクル チャージ ポンプにより 100% の PWM デューティ サイクルをサポート
- 16 レベルのゲートドライブ ピーク電流
 - 16mA~1000mA ソース電流
 - 32mA~2000mA シンク電流
 - ソース - シンク電流比 1:1、1:2、1:3
- 可変 PWM デッドタイム挿入 20ns~900ns
- モーター位相 (SH) スwitching 向けの堅牢な設計
 - スルーレート 50V/μs
 - 負の過渡電圧 -20V
 - 2A の強力なゲート プルダウン
- 冗長シャットダウン用にゲート駆動電源入力を分割 (DRV8162、DRV8162L)
- 低オフセットの電流センス アンプ (DRV8161)
 - 可変ゲイン (5、10、20、40V/V)
- 柔軟な PWM 制御インターフェイス、2 ピン PWM、1 ピン PWM、独立 PWM モード
- 13 レベル VDS 過電流スレッシュホールド
- 独立したシャットダウン ピン (nDRVOFF)
- ゲートドライバ ソフト シャットダウン シーケンス
- 保護機能内蔵
 - GVDD 低電圧 (GVDDUV)
 - ブートストラップ低電圧 (BST_UV)
 - MOSFET 過電流保護 (VDS)
 - 貫通電流保護
 - サーマル シャットダウン (OTSD)
 - フォルト状態インジケータ (nFAULT)
- 3.3V および 5V のロジック入力をサポート

2 アプリケーション

- 産業用ロボット / 協働ロボット (コボット)
- 移動ロボット (AGV/AMR)
- リニア モーター輸送システム
- サーボドライブ
- ドローン
- 電動アシスト自転車、電動スクーター、E-モビリティ

3 説明

DRV816x は、ハイサイドおよびローサイドの N チャンネルパワー MOSFET を駆動できる、ハーフブリッジゲートドライバです。ゲート駆動電圧は GVDD 電源ピンから生成され、内蔵ブートストラップ回路はハイサイド FET を最大 102V ドレインまで駆動するために使用されます。スマートゲートドライブアーキテクチャは、最大でソース 1A、シンク 2A の 16 レベル (48 通りの組み合わせ) のゲート駆動ピーク電流をサポートし、ゲート駆動電流の内蔵タイミング制御機能も搭載しています。これらのデバイスを使用して、ブラシレス/ブラシ付き DC モータ、PMSM、ステッピングモータ、SRM、ソレノイドなど、各種の負荷を駆動できます。

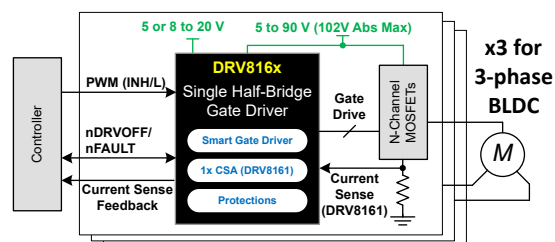
電源低電圧、FET 過電流、ダイ過熱に対する保護機能が内蔵されています。nFAULT ピンは、保護機能によって検出されたフォルト イベントを通知します。nDRVOFF ピンは、PWM 制御から独立して電力段のシャットダウンを開始します。DRV8162 および DRV8162L デバイスは、セーフトルクオフ (STO) 機能を補助するために、分割電源アーキテクチャを採用しています。

ゲート駆動電流、デッドタイム、PWM 制御インターフェイス、過電流検出など、デバイスの多くのパラメータは、いくつかの受動部品をデバイスのピンに接続して構成できます。内蔵のローサイド電流センスアンプ (DRV8161) は、電流測定情報をコントローラに返します。

製品情報

部品番号	パッケージ ⁽¹⁾	パッケージサイズ ⁽²⁾	本体サイズ (公称)
DRV8161	VSSOP (20)	5.1mm × 4.9mm	5.1mm × 3.0mm
DRV8162 ⁽³⁾	VSSOP (20)	5.1mm × 4.9mm	5.1mm × 3.0mm

- 詳細については、[セクション 11](#) を参照してください。
- パッケージサイズ (長さ × 幅) は公称値であり、該当する場合はピンも含まれます。
- DRV8162 および DRV8162L デバイスのバリエーションが含まれません。「[デバイス比較表](#)」を参照してください。



DRV816x の概略回路図



目次

1 特長	1	8 アプリケーションと実装	35
2 アプリケーション	1	8.1 アプリケーション情報.....	35
3 説明	1	8.2 代表的なアプリケーション.....	35
4 デバイス比較表	3	8.3 レイアウト.....	37
5 ピン構成および機能	4	8.4 電源に関する推奨事項.....	38
6 仕様	6	9 デバイスおよびドキュメントのサポート	40
6.1 絶対最大定格.....	6	9.1 デバイス サポート.....	40
6.2 ESD 定格.....	6	9.2 ドキュメントのサポート.....	40
6.3 推奨動作条件.....	7	9.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法.....	40
6.4 熱に関する情報 (1pkg).....	7	9.4 サポート・リソース.....	40
6.5 電気的特性.....	8	9.5 商標.....	40
6.6 タイミング図.....	13	9.6 静電気放電に関する注意事項.....	40
7 詳細説明	15	9.7 用語集.....	40
7.1 概要.....	15	9.8 コミュニティリソース.....	40
7.2 機能ブロック図.....	16	10 改訂履歴	40
7.3 機能説明.....	18	11 メカニカル、パッケージ、および注文情報	41

4 デバイス比較表

デバイス	デバイスの種類	パッケージのピン数	電流検出アンプ	ゲートドライブ電源	最小 GVDD 動作	制御モード
DRV8161	DRV8161	20	あり	GVDD	8V	2ピン、1ピン PWM、独立 FET
DRV8162	DRV8162		なし	GVDD と GVDD_LS	8V	
	DRV8162L				5V	

5 ピン構成および機能

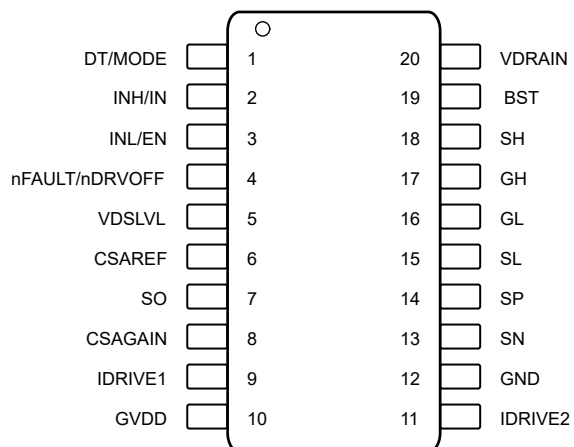


図 5-1. DRV8161 DGS パッケージ 20 ピン VSSOP 上面図

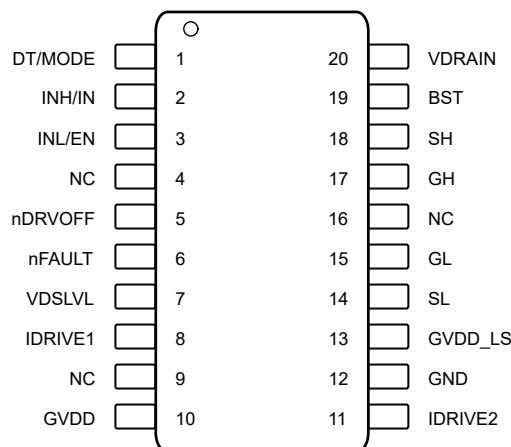


図 5-2. DRV8162 と DRV8162L DGS パッケージ 20 ピン VSSOP 上面図

表 5-1. ピン機能—DRV816x デバイス

名称	ピン		タイプ	説明
	番号			
	DRV8161 20 ピン	DRV8162、 DRV8162L 20 ピン		
DT/ MODE	1	1	I	入力ピンのインターフェイスロジックとゲート駆動デッドタイム設定を選択します。DT と GND の間に抵抗を接続してデッドタイムを 20ns～900ns の範囲で調整し、PWM モードを選択します。
INH/IN	2	2	I	ゲートドライバの制御入力。ゲートドライバの制御は、DT/MODE ピンの設定に依存します。
INL/EN	3	3	I	ゲートドライバの制御入力。ゲートドライバの制御は、DT/MODE ピンの設定に依存します。
NC	—	4	該当なし	未接続。オープンのままにします。
nDRVOFF	—	5	I	ゲートドライバシャットダウン制御。nDRVOFF をローにプルダウンすると、ゲートドライバがプルダウン状態になることで、ハイサイドおよびローサイドの外部 MOSFET がオフになります。
nFAULT / nDRVOFF	4	—	I/OD	共有の故障インジケータピンとゲートドライバシャットダウンピン。このピンをコントローラ電源またはコントローラ出力ピンへの外部プルアップ抵抗に接続します。このピンは、故障状態の間、ロジック low にプルされます。アクティブゲートドライブシャットダウンを有効にするには、外部ロジックによりピンを low にします。
nFAULT	—	6	OD	フォルト通知出力。このピンは故障状態の間はロジック Low にプルされ、コントローラの I/O 電源への外部プルアップ抵抗 (3.3V~5.0V) が必要です。
VDSLVL	5	7	I	VDS 監視スレッショルド設定。このピンは、外部抵抗により設定される多段階入力ピンです。
CSAREF	6	—	PWR	電流センスアンプのリファレンスコンデンサを CSAREF ピンと GND ピンの間に接続します。
SO	7	—	O	電流センスアンプの出力。
CSAGAIN	8	—	I	電流センスアンプのゲイン設定。このピンは、外部抵抗により設定される多段階入力ピンです。
IDRIVE1	9	8	I	ゲート駆動のソースおよびシンク電流設定。このピンは、外部抵抗により設定される多段階入力ピンです。
NC	—	9, 16		未接続。オープンのままにします。

表 5-1. ピン機能—DRV816x デバイス (続き)

名称	ピン		タイプ	説明
	番号			
	DRV8161 20 ピン	DRV8162、 DRV8162L 20 ピン		
GVDD	10	10	PWR	ゲートドライバの電源入力。コンデンサを GVDD ピンと GND ピンの間に接続します。
IDRIVE2	11	11	I	ゲート駆動のソースおよびシンク電流設定。このピンは、外部抵抗により設定される多段階入力ピンです。
GND	12	12	PWR	デバイスのグラウンド。
GVDD_LS	—	13	PWR	ローサイドゲートドライバの電源入力 (DRV8162 および DRV8162L のみ)。コンデンサを GVDD_LS ピンと GND ピンの間に接続します。
SN	13	—	I	電流検出アンプ入力。電流シャント抵抗の低電位側に接続します。
SP	14	—	I	電流シャントアンプの入力。ローサイド パワー MOSFET のソースと電流シャント抵抗の高電位側に接続します。
SL	15	14	I	ローサイド ソース ピン。ローサイド パワー MOSFET のソースに接続します。このピンは VDS 監視用入力でありローサイド ゲートドライバのシンクのための出力です。
GL	16	15	O	ローサイド ゲートドライバ出力。ローサイド パワー MOSFET のゲートに接続します。
GH	17	17	O	ハイサイド ゲートドライバ出力。ハイサイド パワー MOSFET のゲートに接続します。
SH	18	18	I	ハイサイド ソース ピン。ハイサイド パワー MOSFET ソースに接続します。このピンは VDS 監視用入力であり、ハイサイド ゲートドライバのシンクのための出力です。
BST	19	19	O	ブートストラップ出力ピン。BST と SH の間にコンデンサを接続します。
VDRAIN	20	20	PWR	VDS モニタおよびチャージポンプ基準用のハイサイド MOSFET ドレインセンス入力。ハイサイド MOSFET ドレインに接続します。

PWR = 電源、I = 入力、O = 出力、NC = 接続なし、OD = オープンドレイン出力

6 仕様

6.1 絶対最大定格

推奨動作条件範囲内 (特に記述のない限り)⁽¹⁾

		最小値	最大値	単位
ゲートドライバレギュレータピン電圧	GVDD、GVDD_LS	-0.3	20	V
ハイサイドドレインピン電圧	VDRAIN、 $T_J = 25^\circ\text{C}$	-0.3	102	V
ブートストラップピン電圧	BST、 $T_J = 25^\circ\text{C}$	-0.3	115	V
ブートストラップピン電圧	SHを基準としたBST	-0.3	20	V
ロジックピン電圧	nFAULT	-0.3	20	V
	INH (IN)、INL (EN)、nDRVOFF、VDSLVL	-0.3	20	
	DT/MODE、IDRIVE1、IDRIVE2、CSAGAIN	-0.3	6	
ハイサイドゲートドライブピン電圧	Gh、 $T_J = 25^\circ\text{C}$ GVDD $\geq 11\text{V}$	-5	115	V
ハイサイドゲートドライブピン電圧	SHを基準としたGH	-0.3	20	V
ハイサイドソースピン電圧	SH、DC	-5	105	V
過度ハイサイドソースピンマイナス電圧	SH、1 μs	-20		V
ハイサイドソースピンのスルーレート	SH、 $V_{\text{BST-SH}} > 3.5\text{V}$		50	V/ns
ローサイドゲートドライブピン電圧	SLを基準としたGL	-0.3	20	V
ローサイドソース検出ピン電圧	SL	-5	$V_{\text{GVDD}} + 0.3$	V
過度ローサイドソースセンスピンマイナス電圧	SL、1 μs	-16		V
電流検出アンプリファレンス入力ピン電圧	CSAREF	-0.3	5.5	V
シャントアンプ入力ピン電圧	SN、SP	-1	1	V
過渡 500ns シャントアンプ入力ピン電圧	SN、SP、500ns	-16	20	V
シャントアンプ出力ピン電圧	SO	-0.3	$V_{\text{CSAREF}} + 0.3$	V
接合部温度、 T_J		-40	150	$^\circ\text{C}$
保管温度、 T_{stg}		-65	150	$^\circ\text{C}$

(1) 「絶対最大定格」の範囲外の動作は、デバイスの永続的な損傷の原因となる可能性があります。「絶対最大定格」は、これらの条件において、または「推奨動作条件」に示された値を超える他のいかなる条件でも、本製品が正しく動作することを意味するものではありません。「絶対最大定格」の範囲内であっても「推奨動作条件」の範囲外で使用した場合、本デバイスは完全に機能するとは限らず、このことが本デバイスの信頼性、機能、性能に影響を及ぼし、本デバイスの寿命を縮める可能性があります。

6.2 ESD 定格

		値	単位
$V_{\text{(ESD)}}$	静電放電	人体モデル (HBM)、ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 準拠 ⁽¹⁾	± 2000
		デバイス帯電モデル (CDM)、ANSI/ESDA/JEDEC JS-002 に準拠 ⁽²⁾	± 250

(1) JEDEC ドキュメント JEP155 には、500V HBM であれば標準的な ESD 管理プロセスにより安全な製造が可能であると記載されています。

(2) JEDEC ドキュメント JEP157 には、250V CDM であれば標準的な ESD 管理プロセスにより安全な製造が可能であると記載されています。

6.3 推奨動作条件

動作温度範囲内 (特に記述のない限り)

			最小値	公称値	最大値	単位
V _{GVDD}	電源電圧	GVDD、GVDD_LS	8		20	V
	電源電圧 (DRV8162L のみ)	GVDD、GVDD_LS、DRV8162L デバイスバリエーション	5			V
V _{GVDD-SL}	SL に対する電源電圧	GVDD (DRV8161)、GVDD_LS (DRV8162x) はローサイドブリッドライバ PWM 動作	3.5			V
V _{VDRAIN}	ハイサイドドレインピン電圧	V _{DRAIN} 、ローサイドゲート駆動、ハイサイドゲート駆動スイッチング (ブートストラップ付き)	0		90	V
V _{BST-SH}	SH を基準とするブートストラップピンの電圧	BST (V _{BST} - V _{SH})、ハイサイドゲート駆動スイッチング、BST_UV 検出なし、V _{BST-SH} min > V _{BST_UV} max (立ち上がり)、	6.1		20	V
	SH を基準とするブートストラップピンの電圧 (DRV8162L のみ)	BST (V _{BST} - V _{SH})、DRV8162L デバイスバリエーションのみ、ハイサイドゲート駆動スイッチング、BST_UV 検出なし、V _{BST-SH} min > V _{BST_UV} max (立ち上がり)	4.6			V
V _{BST}	ブートストラップピン電圧	BST	0		105	V
V _{SH}	ハイサイドソースピン電圧	SH	-2		95	V
V _I	デジタルピン検出入力電圧	INH、INL、IDRIVE1、IDRIVE2、CSAGAIN、V _{DSLVL} 、nDRVOFF、DT/MODE	0		5.5	V
V _{OD}	オープンドレインプルアップ電圧	nFAULT			5.5	V
I _{OD}	オープンドレイン出力電流	nFAULT			-5	mA
V _{CSAREF}	電流センスアンプリファレンス電圧	CSAREF	3.0		5.5	V
T _A	動作時の周囲温度		-40		125	°C
T _J	動作時接合部温度		-40		150	°C

6.4 熱に関する情報 (1pkg)

熱評価基準 ⁽¹⁾		DRV8161/DRV8162	単位
		DGS (VSSOP)	
		20ピン	
R _{θJA}	接合部から周囲への熱抵抗	87.0	°C/W
R _{θJC(top)}	接合部からケース (上面) への熱抵抗	31.2	°C/W
R _{θJB}	接合部から基板への熱抵抗	42.3	°C/W
Ψ _{JT}	接合部から上面への特性パラメータ	0.9	°C/W
Ψ _{JB}	接合部から基板への特性パラメータ	41.9	°C/W
R _{θJC(bot)}	接合部からケース (底面) への熱抵抗	該当なし	°C/W

(1) 従来および最新の熱評価基準の詳細については、『[半導体および IC パッケージの熱評価基準](#)』アプリケーションレポートを参照してください。

6.5 電気的特性

、 $V_{GVDD} = 12V$ $V_{VDRAIN} = 48V$ 、 $T_J = 25^\circ C$ (特に記述のない限り)

パラメータ		テスト条件	最小値	標準値	最大値	単位
電源 (GVDD、BST)						
I_{VDRAIN_UNP} WR	GVDD 電源が供給されていないときの VDRAIN リーク電流	GVDD = 0V、VDRAIN = 48V、 $V_{BST-SH} = 0V$ VDRAIN+SH のリーク電流		3.5	5	μA
I_{GVDD}	GVDD アクティブ モード電流	INH = INL = 20kHz でスイッチング、 $V_{BST} = V_{GVDD}$ 、FET は接続なし、DT/ MODE ピンはオープン。VDS_LVL = 2V		2		mA
t_{WAKE}	ターンオン時間	GVDD = 0V~12V GVDD_UV からアクティブモード (出力準備 完了) (nFAULT = High)		0.4		ms
$I_{L_BS_TCPON}$	ハイサイドプルアップ中のブートストラップピ ンのリーク電流	INH = High、TCP_ON		30		μA
ロジックレベル入力 (INH、INL、nDRVOFF)						
V_{IL}	入力ロジック Low 電圧	INL、INH、nDRVOFF			0.8	V
V_{IH}	入力ロジック High 電圧	INL、INH、nDRVOFF	2.2			V
R_{PU}	入力プルアップ抵抗	nDRVOFF から内部レギュレータへ、外部 接続なし		250		k Ω
R_{PD}	入力プルダウン抵抗	INH、INL から GND へ		250		k Ω
$t_{nDRVOFF_DE}$ G	nDRVOFF 入力のグリッチ除去時間	DRVOFF の立ち下がりと立ち上がり	1	2.1	4.2	μs
$t_{nDRVOFF_DI}$ AG	nDRVOFF 診断パルスの有効入力時間	DRV8162 および DRV8162L のみ		0.5		μs
オープンドレイン出力 (nFAULT)						
V_{OL}	出力ロジック Low 電圧	$I_{OD} = 5mA$ 、GVDD > 4V			0.4	V
ブートストラップダイオード (BST)						
V_{BOOTD}	ブートストラップ ダイオードの順方向電圧	$I_{BOOT} = 100 \mu A$		0.82		V
V_{BOOTD}	ブートストラップ ダイオードの順方向電圧	$I_{BOOT} = 100 mA$		1.6		V
R_{BOOTD}	ブートストラップの動的抵抗 ($\Delta V_{BOOTD}/$ ΔI_{BOOT})	$I_{BOOT} = 100mA$ および 50mA	3.9	4.8	9	Ω
チャージポンプ (BST)						
V_{TCP}	トリクルチャージポンプの出力電圧	V_{BST-SH} 、INH = High、SH = VDRAIN = 20V、BST > GVDD、外部負荷 $I_{TRICKLE} =$ 2 μA	9.5	10.6	12	V
t_{TCP_DLY}	トリクルチャージポンプのアクティブ遅延時 間	INL = Low	150	250	350	μs
ゲートドライバ (GH、GL、SH、SL)						
V_{GSHx_LO}	ハイサイド ゲート駆動の low レベル電圧 ($V_{GH} - V_{SH}$)	$I_{GHx} = -10mA$ 、 $V_{GVDD} = 12V$ 、IDRIVE = 1000mA、FET は接続されていない	0	0.022	0.2	V
V_{GSHx_HI}	ハイサイドゲート駆動の High レベル電圧 ($V_{BST} - V_{GH}$)	$I_{GHx} = 10mA$ 、 $V_{GVDD} = 12V$ 、IDRIVE = 500mA、FET は接続されていない	0	0.09	0.2	V
V_{GSLx_LO}	ローサイド ゲート駆動の low レベル電圧 ($V_{GL} - V_{SL}$)	$I_{GLx} = -10mA$ 、 $V_{GVDD} = 12V$ 、IDRIVE = 1000mA、FET は接続されていない	0	0.022	0.2	V
V_{GSLx_HI}	ローサイド ゲート駆動の High レベル電圧 ($V_{GVDD} - V_{GL}$)	$I_{GLx} = 10mA$ 、 $V_{GVDD} = 12V$ 、IDRIVE = 500mA、FET は接続されていない	0	0.09	0.2	V

、 $V_{GVDD} = 12V$ $V_{VDRAIN} = 48V$ 、 $T_J = 25^\circ C$ (特に記述のない限り)

パラメータ		テスト条件	最小値	標準値	最大値	単位
$I_{DRIVEP0}$	ピーク ソースゲート電流	$V_{BST} - V_{SH} = V_{GVDD} = 12V$ 、 $T_J = -40^\circ C \sim 150^\circ C$	9	16	26	mA
$I_{DRIVEP1}$		$V_{BST} - V_{SH} = V_{GVDD} = 12V$ 、 $T_J = -40^\circ C \sim 150^\circ C$	19	32	52	mA
$I_{DRIVEP2}$		$V_{BST} - V_{SH} = V_{GVDD} = 12V$ 、 $T_J = -40^\circ C \sim 150^\circ C$	38	64	103	mA
$I_{DRIVEP3}$		$V_{BST} - V_{SH} = V_{GVDD} = 12V$ 、 $T_J = -40^\circ C \sim 150^\circ C$	57	96	154	mA
$I_{DRIVEP4}$		$V_{BST} - V_{SH} = V_{GVDD} = 12V$ 、 $T_J = -40^\circ C \sim 150^\circ C$	76	128	205	mA
$I_{DRIVEP5}$		$V_{BST} - V_{SH} = V_{GVDD} = 12V$ 、 $T_J = -40^\circ C \sim 150^\circ C$	96	160	256	mA
$I_{DRIVEP6}$		$V_{BST} - V_{SH} = V_{GVDD} = 12V$ 、 $T_J = -40^\circ C \sim 150^\circ C$	115	192	308	mA
$I_{DRIVEP7}$		$V_{BST} - V_{SH} = V_{GVDD} = 12V$ 、 $T_J = -40^\circ C \sim 150^\circ C$	134	224	359	mA
$I_{DRIVEP8}$		$V_{BST} - V_{SH} = V_{GVDD} = 12V$ 、 $T_J = -40^\circ C \sim 150^\circ C$	153	256	410	mA
$I_{DRIVEP9}$		$V_{BST} - V_{SH} = V_{GVDD} = 12V$ 、 $T_J = -40^\circ C \sim 150^\circ C$	172	288	461	mA
$I_{DRIVEP10}$		$V_{BST} - V_{SH} = V_{GVDD} = 12V$ 、 $T_J = -40^\circ C \sim 150^\circ C$	192	320	512	mA
$I_{DRIVEP11}$		$V_{BST} - V_{SH} = V_{GVDD} = 12V$ 、 $T_J = -40^\circ C \sim 150^\circ C$	230	384	615	mA
$I_{DRIVEP12}$		$V_{BST} - V_{SH} = V_{GVDD} = 12V$ 、 $T_J = -40^\circ C \sim 150^\circ C$	268	448	717	mA
$I_{DRIVEP13}$		$V_{BST} - V_{SH} = V_{GVDD} = 12V$ 、 $T_J = -40^\circ C \sim 150^\circ C$	307	512	820	mA
$I_{DRIVEP14}$		$V_{BST} - V_{SH} = V_{GVDD} = 12V$ 、 $T_J = -40^\circ C \sim 150^\circ C$	460	768	1229	mA
$I_{DRIVEP15}$		$V_{BST} - V_{SH} = V_{GVDD} = 12V$ 、 $T_J = -40^\circ C \sim 150^\circ C$	614	1024	1639	mA

DRV8161, DRV8162

JAJSQL1C – MAY 2024 – REVISED FEBRUARY 2025

 、 $V_{GVDD} = 12V$ $V_{VDRAIN} = 48V$ 、 $T_J = 25^\circ C$ (特に記述のない限り)

パラメータ		テスト条件	最小値	標準値	最大値	単位
$I_{DRIVEN0}$	ピーク シンクゲート電流	$V_{BST} - V_{SH} = V_{GVDD} = 12V$ 、 $T_J = -40^\circ C \sim 150^\circ C$	19	32	52	mA
$I_{DRIVEN1}$		$V_{BST} - V_{SH} = V_{GVDD} = 12V$ 、 $T_J = -40^\circ C \sim 150^\circ C$	38	64	103	mA
$I_{DRIVEN2}$		$V_{BST} - V_{SH} = V_{GVDD} = 12V$ 、 $T_J = -40^\circ C \sim 150^\circ C$	76	128	205	mA
$I_{DRIVEN3}$		$V_{BST} - V_{SH} = V_{GVDD} = 12V$ 、 $T_J = -40^\circ C \sim 150^\circ C$	115	192	308	mA
$I_{DRIVEN4}$		$V_{BST} - V_{SH} = V_{GVDD} = 12V$ 、 $T_J = -40^\circ C \sim 150^\circ C$	153	256	410	mA
$I_{DRIVEN5}$		$V_{BST} - V_{SH} = V_{GVDD} = 12V$ 、 $T_J = -40^\circ C \sim 150^\circ C$	192	320	512	mA
$I_{DRIVEN6}$		$V_{BST} - V_{SH} = V_{GVDD} = 12V$ 、 $T_J = -40^\circ C \sim 150^\circ C$	230	384	615	mA
$I_{DRIVEN7}$		$V_{BST} - V_{SH} = V_{GVDD} = 12V$ 、 $T_J = -40^\circ C \sim 150^\circ C$	268	448	717	mA
$I_{DRIVEN8}$		$V_{BST} - V_{SH} = V_{GVDD} = 12V$ 、 $T_J = -40^\circ C \sim 150^\circ C$	307	512	820	mA
$I_{DRIVEN9}$		$V_{BST} - V_{SH} = V_{GVDD} = 12V$ 、 $T_J = -40^\circ C \sim 150^\circ C$	345	576	922	mA
$I_{DRIVEN10}$		$V_{BST} - V_{SH} = V_{GVDD} = 12V$ 、 $T_J = -40^\circ C \sim 150^\circ C$	384	640	1024	mA
$I_{DRIVEN11}$		$V_{BST} - V_{SH} = V_{GVDD} = 12V$ 、 $T_J = -40^\circ C \sim 150^\circ C$	460	768	1229	mA
$I_{DRIVEN12}$		$V_{BST} - V_{SH} = V_{GVDD} = 12V$ 、 $T_J = -40^\circ C \sim 150^\circ C$	537	896	1434	mA
$I_{DRIVEN13}$		$V_{BST} - V_{SH} = V_{GVDD} = 12V$ 、 $T_J = -40^\circ C \sim 150^\circ C$	614	1024	1639	mA
$I_{DRIVEN14}$		$V_{BST} - V_{SH} = V_{GVDD} = 12V$ 、 $T_J = -40^\circ C \sim 150^\circ C$	921	1536	2458	mA
$I_{DRIVEN15}$	$V_{BST} - V_{SH} = V_{GVDD} = 12V$ 、 $T_J = -40^\circ C \sim 150^\circ C$	1228	2048	3277	mA	
R_{PD_LS}	ローサイド パッシブ ブルダウン	GL から SL、 $V_{GL} - V_{SL} = 2V$	60	85	120	k Ω
R_{PDSA_HS}	ハイサイド セミアクティブ ブルダウン	$V_{GVDD} < V_{GVDD_UV}$ GH \sim SH、 $V_{GH} - V_{SH} = 2V$	2	4	8	k Ω
I_{PUHOLD_HS}	ハイサイドブルアップホールド電流	$T_J = -40 \sim 150^\circ C$	307	512	820	mA
I_{PDHOLD_HS}	ハイサイドブルダウンホールド電流	$T_J = -40 \sim 150^\circ C$	1228	2048	3277	mA
$I_{PDSTRONG_LS}$	ローサイド・ブルダウン強電流	$T_J = -40 \sim 150^\circ C$	1228	2048	3277	mA
$I_{PDSTRONG_HS}$	ハイサイドブルダウン強電流	$T_J = -40 \sim 150^\circ C$	1228	2048	3277	mA
$I_{DRIVENS_D_LS}$	ローサイド ピーク シンク ゲートシャットダウン電流	$I_{DRIVENx}$ は $I_{DRIVEN13}$ (1024mA 標準値) またはそれ以下の設定に設定されます		32		mA
$I_{DRIVENS_D_LS}$	ローサイド ピーク シンク ゲートシャットダウン電流	$I_{DRIVENx}$ は $I_{DRIVEN14}$ (1536mA 標準値) または $I_{DRIVEN15}$ (2048mA 標準値) に設定されます。		64		mA
$I_{DRIVENS_D_HS}$	ハイサイド ピーク シンク ゲートシャットダウン電流	$I_{DRIVENx}$ は $I_{DRIVEN13}$ (1024mA 標準値) またはそれ以下の設定に設定されます		32		mA
$I_{DRIVENS_D_HS}$	ハイサイド ピーク シンク ゲートシャットダウン電流	$I_{DRIVENx}$ は $I_{DRIVEN14}$ (1536mA 標準値) または $I_{DRIVEN15}$ (2048mA 標準値) に設定されます。		64		mA

、 $V_{GVDD} = 12V$ $V_{VDRAIN} = 48V$ 、 $T_J = 25^\circ C$ (特に記述のない限り)

パラメータ		テスト条件	最小値	標準値	最大値	単位
ゲートドライバのタイミング						
t_{PDR_LS}	ローサイド立ち上がり伝搬遅延	INL から GL 立ち上がりまで、 $V_{GVDD} > 8V$	25	40	80	ns
t_{PDF_LS}	ローサイド立ち下がり伝搬遅延	INL から GL 立ち下がりまで、 $V_{GVDD} > 8V$	25	41	80	ns
t_{PDR_HS}	ハイサイド立ち上がり伝搬遅延	INH から GH 立ち上がりまで、 $V_{GVDD} = V_{BST} - V_{SH} > 8V$	25	41	80	ns
t_{PDF_HS}	ハイサイド立ち下がり伝搬遅延	INH から GH 立ち下がりまで、 $V_{GVDD} = V_{BST} - V_{SH} > 8V$	25	42	80	ns
t_{PD_MATCH}	ローサイドゲートドライバの伝搬遅延の一致	GL ターンオンから GL ターンオフまで、 $V_{GL-SL} = 1V$ から $V_{GL-SL} = V_{GVDD} - 1V$ 、 $V_{GVDD} = V_{BST} - V_{SH} > 8V$ 、 $V_{SH} = 0V \sim 90V$ 、GH と GL は無負荷	-10	± 4	10	ns
	ハイサイドゲートドライバの伝搬遅延の一致	GH ターンオンから GH ターンオフまで、 $V_{GH-SH} = 1V$ から $V_{GH-SH} = V_{BST-SH} - 1V$ 、 $V_{GVDD} = V_{BST} - V_{SH} > 8V$ 、 $V_{SH} = 0V \sim 90V$ 、GH と GL は無負荷	-10	± 4	10	ns
$t_{PD_MATCH_PH}$	位相ごとの伝搬遅延のマッチング	デッドタイムの無効化。GL ターンオフから GH ターンオンまで、 $V_{GL-SL} = V_{GVDD} - 1V$ から $V_{GH-SH} = 1V$ 、 $V_{GVDD} = V_{BST} - V_{SH} > 8V$ 、 $V_{SH} = 0V \sim 90V$ 、GH と GL は無負荷、デッドタイムは無効化	-12	± 4	12	ns
		デッドタイムの無効化。GH ターンオフから GL ターンオンまで、 $V_{GH-SH} = V_{BST-SH} - 1V$ から $V_{GL-SL} = 1V$ 、 $V_{GVDD} = V_{BST} - V_{SH} > 8V$ 、 $V_{SH} = 0V \sim 90V$ 、GH と GL は無負荷	-10	± 4	10	ns
t_{DEAD}	ゲート駆動デッド タイム	$R_{DT} = 470 \Omega$ 2ピン PWM モード。		20		ns
t_{DEAD}	ゲート駆動デッド タイム	$R_{DT} = 1.3K\Omega$ 2ピン PWM モード、	97	100	120	ns
t_{DEAD}	ゲート駆動デッド タイム	$R_{DT} = 3.3K\Omega$ 2ピン PWM モード、	316	370	422	ns
t_{DEAD_CFG}	ゲート駆動デッドタイム設定範囲	Tdead リニア設定 $R_{DT} = 10K\Omega \sim 1M\Omega$ 、1ピン PWM モード	20		900	ns
t_{DEAD}	ゲート駆動デッド タイム	$R_{DT} = 990K\Omega$ 1ピン PWM モード、 $T_J = -40 \sim 150^\circ C$	700	900	1250	ns
$t_{MINDEAD_VGS_HS}$	VGS 監視モードの最小ゲート駆動デッドタイム(最短利用可能)、HS 立ち下がりから LS 立ち上がりまで	VGS モニタデッドタイム挿入モード。 $t_{DEAD_CFG} < 130ns$ 、 $V_{GVDD} > 8V$ 、 $V_{BST-SH} > 8V$ 、 $0V < V_{SH} \leq 90V$		215		ns
$t_{MINDEAD_VGS_LS}$	VGS 監視モードの最小ゲート駆動デッドタイム(最短利用可能)、LS 立ち下がりから HS 立ち上がりまで	VGS モニタデッドタイム挿入、 $t_{DEAD_CFG} < 130ns$ 、 $V_{GVDD} > 8V$ 、 $V_{BST-SH} > 8V$ 、 $0V < V_{SH} \leq 90V$		225		ns
t_{DRVN_SD}	シャットダウン中のゲートドライバのブルダウニング			20		μs
電流シャントアンプ (SN、SO、SP、CSAREF)						
A_{CSA}	検出アンプのゲイン	CSAGAIN = GND に接続 (LEVEL0)		5		V/V
		CSAGAIN = の 10k Ω (標準値) を GND に接続 (LEVEL1)		10		V/V
		CSAGAIN = の 30k Ω (標準値) を GND に接続 (LEVEL2)		20		V/V
		CSAGAIN = オープン、(LEVEL3)		40		V/V
$A_{CSA_ERR_DRIFT}$	検出アンプのゲイン誤差の温度ドリフト	$T_J = -40^\circ C \sim 150^\circ C$	-70		70	ppm/ $^\circ C$

DRV8161, DRV8162

JAJSQL1C – MAY 2024 – REVISED FEBRUARY 2025

 $V_{GVDD} = 12V$, $V_{VDRAIN} = 48V$, $T_J = 25^\circ C$ (特に記述のない限り)

パラメータ		テスト条件	最小値	標準値	最大値	単位
t_{SET}	$\pm 1\%$ までのセトリング タイム	$V_{STEP} = 1.6V$, $A_{CSA} = 5V/V$, $C_{SO} = 500pF$		0.6		μs
		$V_{STEP} = 1.6V$, $A_{CSA} = 40V/V$, $C_{SO} = 500pF$		0.8		μs
BW	帯域幅	$A_{CSA} = 5V/V$, $C_{LOAD} = 60pF$, 小信号 -3dB	3	5	7	MHz
V_{SWING}	出力電圧範囲	$V_{CSAREF} = 3 \sim 5.5V$	0.25		$V_{CSAREF} - 0.25$	V
V_{COM}	同相入力範囲		-0.225		0.225	V
V_{OFF}	入力オフセット電圧	$V_{SP} = V_{SN} = GND$, $T_J = 25^\circ C$, ゲイン $A_{CSA} = 10, 20, 40V/V$	-1.94		1.94	mV
V_{OFF}	入力オフセット電圧	$V_{SP} = V_{SN} = GND$, $T_J = 25^\circ C$, ゲイン $A_{CSA} = 5V/V$	-3.34		3.34	mV
V_{OFF_DRIFT}	入力オフセット電圧ドリフト	$V_{SP} = V_{SN} = GND$		8		$\mu V/^\circ C$
V_{BIAS}	出力電圧バイアス比	$V_{SP} = V_{SN} = GND$		0.5		
I_{BIAS}	入力バイアス電流	$V_{SP} = V_{SN} = GND$, $V_{CSAREF} = 3V \sim 5.5V$			100	μA
I_{BIAS_OFF}	入力バイアス電流オフセット	$I_{SP} - I_{SN}$	-1		1	μA
CMRR	同相除去比	DC		80		dB
		20 kHz		60		dB
I_{CSA_SUP}	CSA の消費電流	$CSAREF$, $V_{CSAREF} = 3V \sim 5.5V$		1.5		mA
T_{CMREC}	同相復帰時間			2		us
保護回路						
V_{GVDD_UV}	GVDD 低電圧スレッシュホールド	V_{GVDD} 立ち上がり		7.4		V
		V_{GVDD} 立ち下がり		6.7		V
V_{GVDD_UV}	GVDD 低電圧スレッシュホールド	V_{GVDD} 立ち上がり, DRV8162L		4.8		V
		V_{GVDD} 立ち下がり, DRV8162L		4.7		V
$t_{GVDD_UV_DG}$	GVDD 低電圧グリッチ除去時間		5	10	15	μs
V_{BST_UV}	ブートストラップ低電圧スレッシュホールド	$V_{BST} - V_{SH}$, V_{BST} 立ち上がり, $GVDD = 12V$		7.43		V
	ブートストラップ低電圧スレッシュホールド	$V_{BST} - V_{SH}$, V_{BST} 立ち下がり, $GVDD = 12V$		7.25		V
	ブートストラップ低電圧スレッシュホールド	$V_{BST} - V_{SH}$, V_{BST} 立ち上がり, $GVDD = 5V$, DRV8162L		4.08		V
	ブートストラップ低電圧スレッシュホールド	$V_{BST} - V_{SH}$, V_{BST} 立ち下がり, $GVDD = 5V$, DRV8162L		3.94		V

、 $V_{GVDD} = 12V$ $V_{VDRAIN} = 48V$ 、 $T_J = 25^\circ C$ (特に記述のない限り)

パラメータ	テスト条件	最小値	標準値	最大値	単位	
V_{DS_LVL0-0}	$R_{VDSLVL} =$:最大 $0.1K\Omega$ (LEVEL0)	0.087	0.1	0.116	V	
V_{DS_LVL1-1}	$R_{VDSLVL} = 2K\Omega$ (LEVEL1)、 V_{DSSLVL} ピンで1つのパルスが検出されました	0.136	0.15	0.166		
V_{DS_LVL1-0}	$R_{VDSLVL} = 2K\Omega$ (標準値、LEVEL1)、DC	0.187	0.2	0.217		
V_{DS_LVL2-1}	$R_{VDSLVL} = 5.6K\Omega$ (標準値) (LEVEL2)、 V_{DSSLVL} ピンで1つのパルスが検出されました	0.28	0.3	0.319		
V_{DS_LVL2-0}	$R_{VDSLVL} = 5.6K\Omega$ (標準値) (LEVEL2)	0.38	0.4	0.42		
V_{DS_LVL3-1}	$R_{VDSLVL} = 12K\Omega$ (標準値) (LEVEL3)、 V_{DSSLVL} ピンで1つのパルスが検出されました	0.482	0.5	0.53		
V_{DS_LVL3-0}	$R_{VDSLVL} = 12K\Omega$ (標準値) (LEVEL3)	0.575	0.6	0.623		
V_{DS_LVL4-1}	$R_{VDSLVL} = 26K\Omega$ (標準値) (LEVEL4)、 V_{DSSLVL} ピンで1つのパルスが検出されました	0.67	0.7	0.73		
V_{DS_LVL4-0}	$R_{VDSLVL} = 26K\Omega$ (標準値) (LEVEL4)	0.765	0.8	0.83		
V_{DS_LVL5-1}	$R_{VDSLVL} = 62K\Omega$ (標準値) (LEVEL5)、 V_{DSSLVL} ピンで1つのパルスが検出されました	0.87	0.9	0.934		
V_{DS_LVL5-0}	$R_{VDSLVL} = 62K\Omega$ (標準値) (LEVEL5)	0.96	1.0	1.04		
V_{DS_LVL6-1}	$R_{VDSLVL} = 130K\Omega$ (標準値) (LEVEL6)、 V_{DSSLVL} ピン V_{DSSLVL} で1つのパルスが検出されました	1.46	1.5	1.548		
V_{DS_LVL6-0}	$R_{VDSLVL} = 130K\Omega$ (標準値) (LEVEL6)	1.945	2.0	2.05		
t_{DS_DG}	V_{DS} 保護グリッチ除去時間		3		μs	
t_{DS_BLK}	V_{DS} 過電流保護ブランキング時間		1		μs	
t_{CLRFLT}	V_{DS} 過電流保護故障クリア時間	INH= INL = Low	250		μs	
$t_{VDSLVLFIL}$	V_{DSSLVL} 1 パルスフィルタ時間		4		μs	
$V_{IHVDSLVL}$	V_{DSSLVL} 1 パルス ハイレベル検出電圧		1		V	
T_{OTSD}	サーマル シャットダウン温度	T_J 立ち上がり、	158	170	187	$^\circ C$
T_{HYS}	サーマル シャットダウン ヒステリシス		7	8.5	10	$^\circ C$

6.6 タイミング図

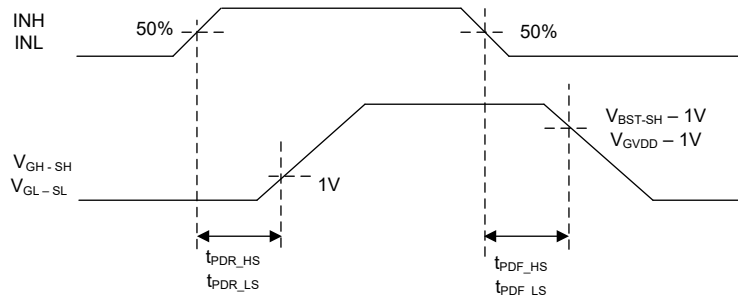


図 6-1. ゲートドライバの伝搬遅延タイミング図

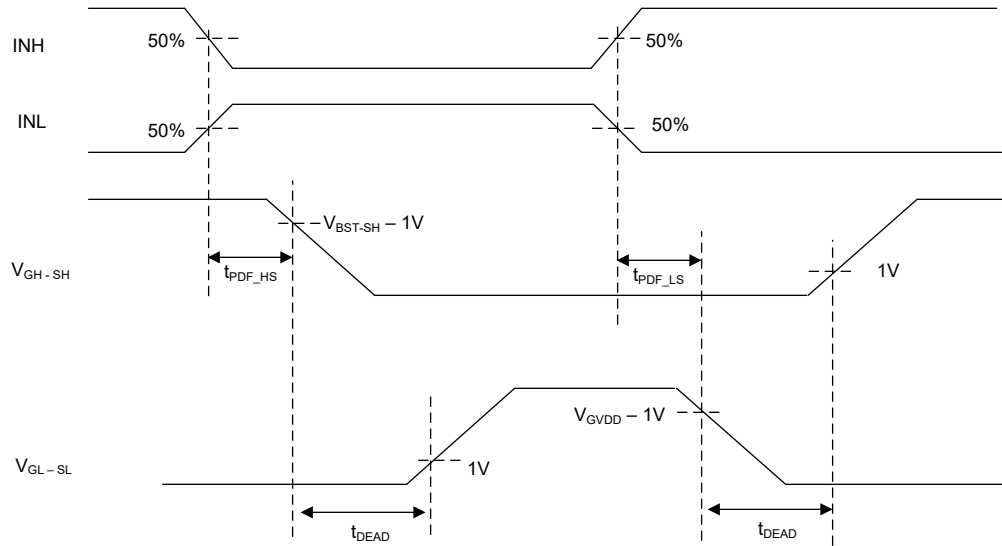


図 6-2. ゲートドライバのデッドタイミングの挿入 (INH および INL モニタモード)

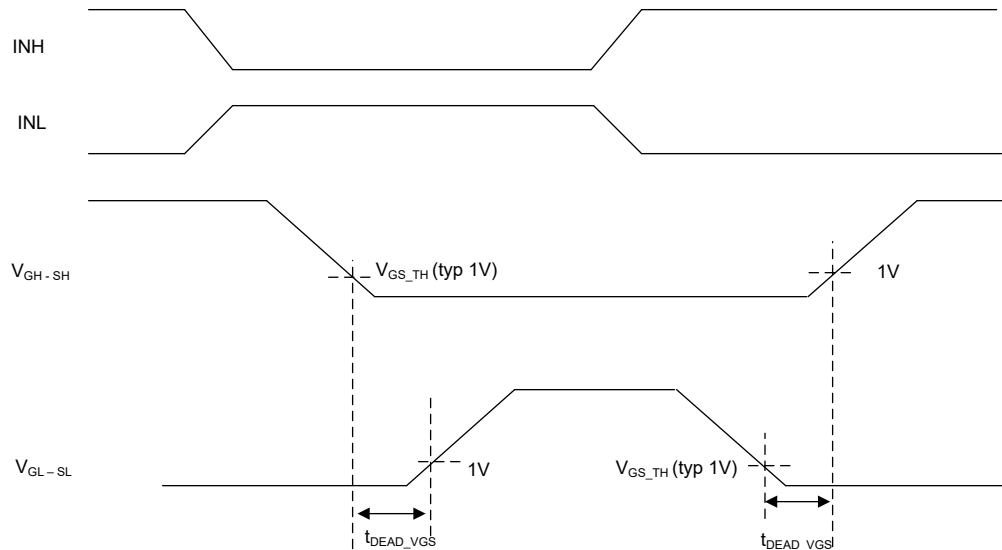


図 6-3. ゲートドライバのデッドタイミング挿入 (VGS モニタモード)

7 詳細説明

7.1 概要

DRV816x デバイスは、ブラシレス DC (BLDC) モーター、ブラシ付き DC モーター、ステッパモーター、スイッチリラクタンスマーター、ソレノイドなど、さまざまな電気機械的負荷に対する統合型 100V ゲートドライバです。これらのデバイスでは、ハーフブリッジゲートドライバとトリクルチャージポンプ、ブートストラップダイオード、FET VDS 監視機能を統合することで、システムコンポーネントの数、コスト、複雑性を削減します。FET VDS モニタは、電源、接地、またはモータ端子間の短絡から外部 FET を保護します。DRV8161 は、コントローラの ADC への電流フィードバック用に、低側双方向電流センスアンプを内蔵しています。ハーフブリッジアーキテクチャにより、ゲートドライバを電源段 FET の近くに配置することができ、信号経路を簡素化し、放射 EMI を低減し、PCB の面積を全体的に削減することができます。

本ゲートドライバは外付け N チャンネル ハイサイド/ローサイド パワー MOSFET をサポートしており、最大 1A (ソース)/2A (シンク) のピーク電流を駆動することができます。内蔵ブートストラップダイオード、外付けブートストラップコンデンサ、内蔵トリクルチャージポンプにより、GVDD ピンからハイサイドゲートドライブ電源電圧が生成されます。GVDD ピンはローサイドゲートドライブ電源電圧を直接供給します。DRV8162 および DRV8162L のデバイスバリエーションは、個別の GVDD および GVDD_LS ピンを装備してセーフトルクオフ (STO) のシステム設計をサポートします。

スマート ゲートドライブ アーキテクチャは出力ゲート駆動電流強度を動的に調整する機能を備えているため、ゲートドライバはパワー MOSFET の VDS スイッチング速度を制御できます。このため、外付けゲート駆動抵抗およびダイオードが不要になり、BOM の部品点数、コスト、PCB 面積の低減が可能です。このアーキテクチャでは、ゲート駆動の短絡に対する保護、ハーフブリッジのデッドタイムの制御、外部パワー MOSFET の dV/dt 寄生ターンオンに対する保護のために、内部ステートマシンも使っています。

高いレベルでデバイスが統合されていることに加え、DRV816x のデバイスには、広範な保護機能も組み込まれています。これらの機能には、電源電圧低下ロックアウト (UVLO)、VDS 過電流モニタリング (OCP)、過熱シャットダウン (OTSD) が含まれます。nFAULT ピンは、保護機能によって検出されたフォルトイベントを通知します。

7.2 機能ブロック図

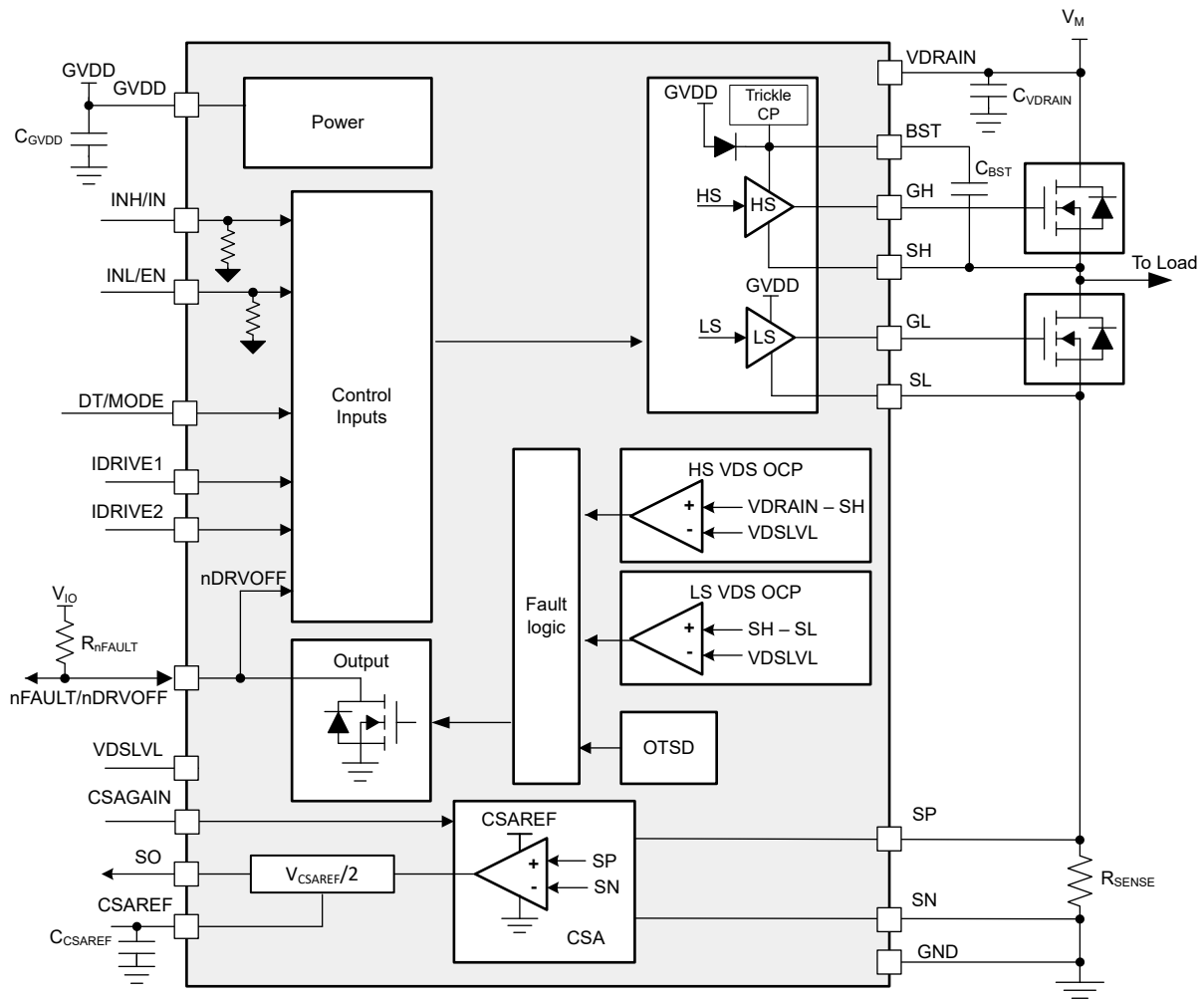


図 7-1. DRV8161 のブロック図

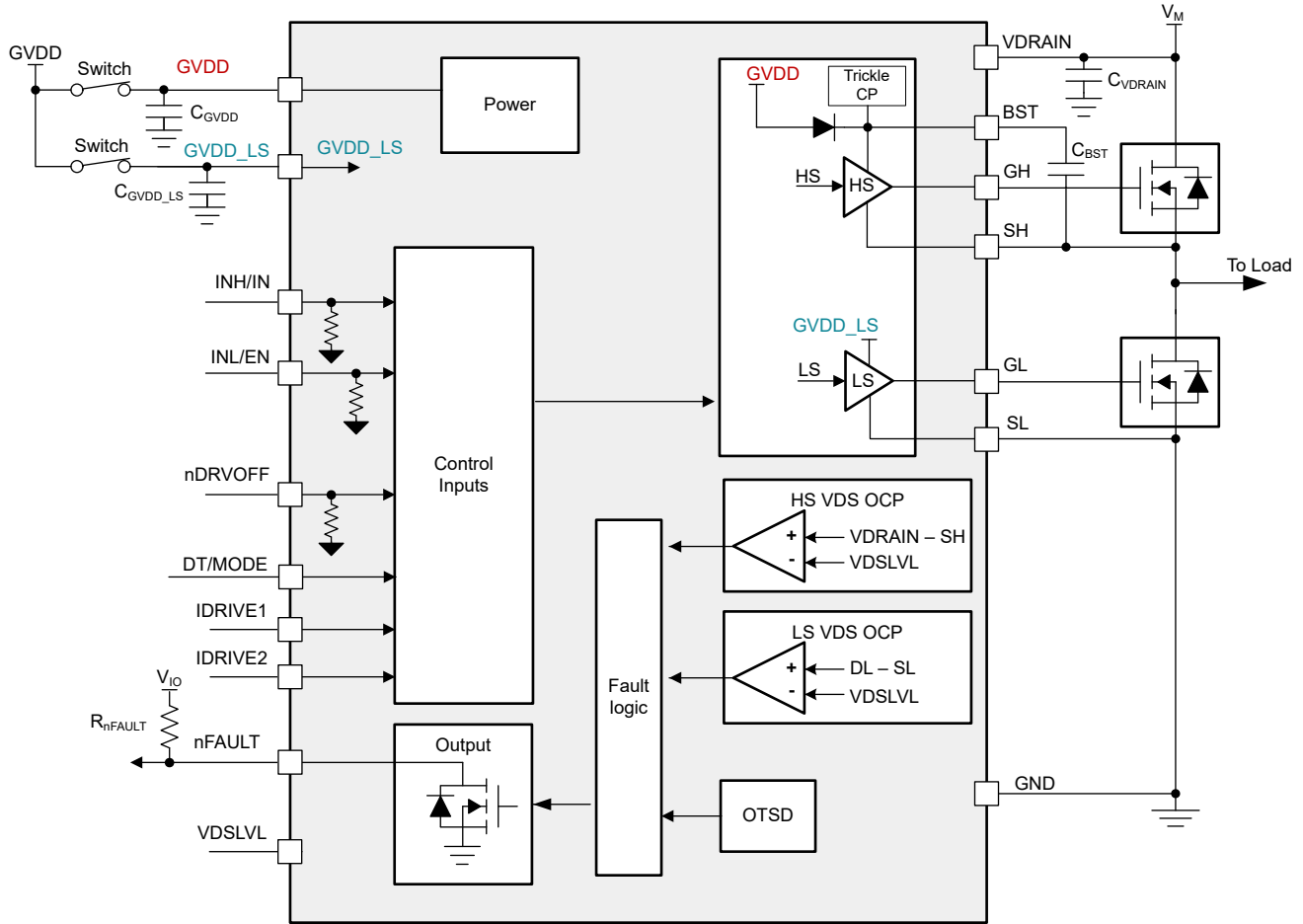


図 7-2. DRV8162 および DRV8162L のブロック図

7.3 機能説明

7.3.1 ゲートドライバ

DRV816x ファミリのデバイスには、ハーフブリッジ構成の N チャネルパワー MOSFET を駆動できるハイサイドとローサイドの FET ゲートドライバが統合されています。ブートストラップゲート駆動アーキテクチャは、PWM スwitchング中にハイサイドゲートドライバ電圧を生成します。GVDD ピンはハイサイドとローサイドの両方のゲートドライバに電源を供給し、FET の V_{GS} 電圧を設定します。

DRV816x、ハーフブリッジ電力ステージアーキテクチャをサポートしています。このデバイスは、通常の 2 ピン PWM、1 ピン PWM 制御インターフェイスに加え、シュートスルー保護を無効にし、ハイサイドとローサイドの FET を個別に制御することで、独立した PWM モードを提供します。独立した FET 制御は、ソレノイドおよびスイッチトリラクタンスモーターの駆動に便利です。DRV8162 と DRV8162L には、ハイサイドとローサイドの FET ゲート駆動用に独立した電源ピン (GVDD と GVDD_LS) があります。これによって、システムはゲート駆動電源ピンに外部パワースイッチを追加することで、セーフトルクオフ (STO) 機能に対応できます。

7.3.1.1 PWM 制御モード

DRV816x ファミリのデバイスには、さまざまな整流方式や制御方式をサポートするために、3 種類の PWM 制御モードが用意されています。PWM 制御モードは、1 ピン PWM、2 ピン PWM、独立 PWM モードです。これらのモードは DT/MODE ピンによって構成されます。

電源投入時に DT/MODE ピンはラッチされるため、PWM 制御モードを変更するには、電源によってデバイスをリセットする必要があります。DT/MODE ピンを使用した PWM 制御モードの構成については、表 7-6 を参照してください。

7.3.1.1.1 2 ピン PWM モード

2 ピン PWM モードでは、ハーフブリッジドライバは、lowhigh、または ハイインピーダンス (Hi-Z) の 3 つの出力状態をサポートします。表 7-1 に示すように、対応する INH および INL 信号で出力状態を制御します。

表 7-1. 2 ピン PWM モードの真理値表

INL	INH	GL	GH	SH
0	0	L	L	ハイインピーダンス
0	1	L	H	H
1	0	H	L	L
1	1	L	L	ハイインピーダンス

7.3.1.1.2.1 ピンPWM モード

1ピン PWM モードでは、IN ピンでハーフブリッジを制御し、Low または High の 2 つの出力状態がサポートされます。EN ピンは、ハーフブリッジを Hi-Z 状態にするために使用します。Hi-Z 状態にする必要がない場合は、INL/EN ピンをロジックハイに固定してください。表 7-2 に示すように、対応する INH/IN および INL/EN 信号で出力状態を制御します。

表 7-2. 1 ピン PWM モードの真理値表

INL/EN	INH/IN	GL	GH	SH
0	X	L	L	ハイインピーダンス
1	0	H	L	L
1	1	L	H	H

7.3.1.1.3 独立 PWM モード

DRV816x は独立 PWM モードをサポートしており、INH および INL ピンはそれぞれ出力 GH および GL を制御します。この制御モードでは、デバイスは独立したハイサイド負荷とローサイド負荷を駆動できます。独立 PWM 駆動モードは、ソレノイド、スイッチドリラクタンスモータ (SRM)、単方向ブラシ付き DC モータ、ローサイドおよびハイサイドスイッチなど、さまざまなタイプの負荷に使用できます。このモードでは、特定のハーフブリッジゲートドライバでハイサイドとローサイド両方の MOSFET を同時にオンにすることで、このデバイスをハイサイドまたはローサイドドライバとして使用できます。モードでは、貫通電流保護とデッドタイムはバイパスされます。

表 7-3. 独立 PWM モードの真理値表

INL	INH	GL	GH
0	0	L	L
0	1	L	H
1	0	H	L
1	1	H	H

図 7-3 は、このデバイスを使用して誘導負荷を接続する方法を示しており、ハイサイドとローサイドの MOSFET を同時にオンにして負荷を駆動し、貫通電流を発生させないことを可能にします。電流再循環用の外付けダイオードを推奨します。この構成は、ソレノイドまたはアプリケーションの設計に役立ちます。トリクルチャージポンプは、ローサイド PWM 動作に関係なく常時有効化されます。

注

独立 PWM モードが構成されている場合、DRV816x のローサイド VDS 監視は利用できません。DRV8161 の場合、MCU によって CSA 出力を監視して過電流状態を検出できます。

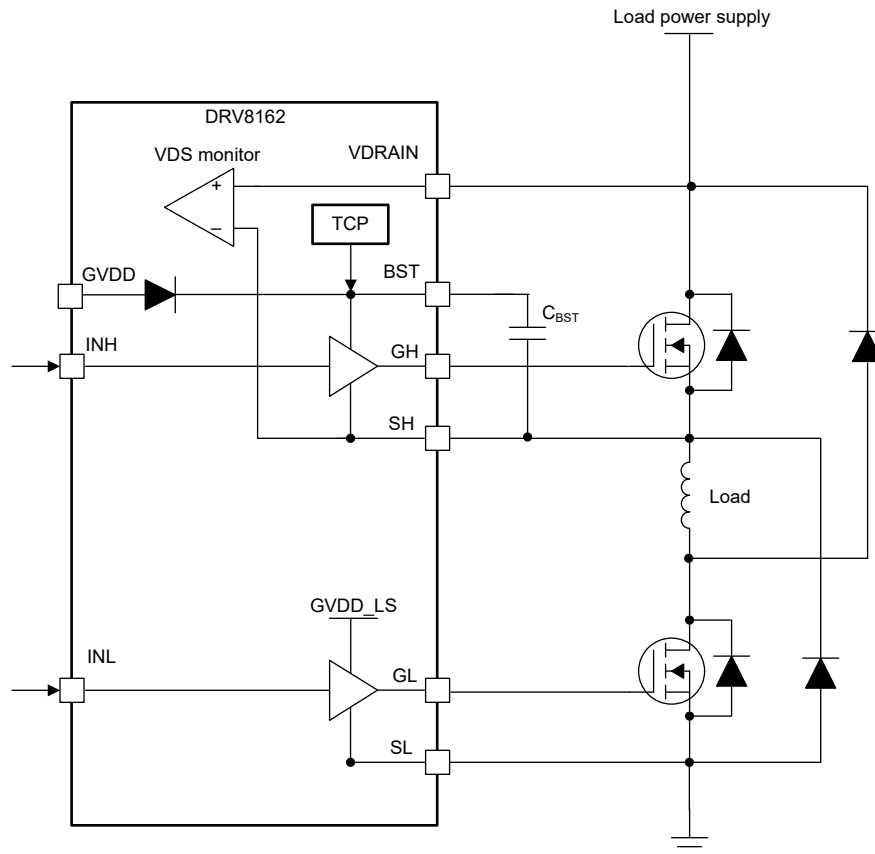


図 7-3. ハイサイドとローサイド間の単一負荷向けの独立 PWM モード

図 7-4 は、1 つのハーフブリッジでハイサイド負荷とローサイド負荷を同時に接続し、負荷を個別に駆動する方法を示しています。

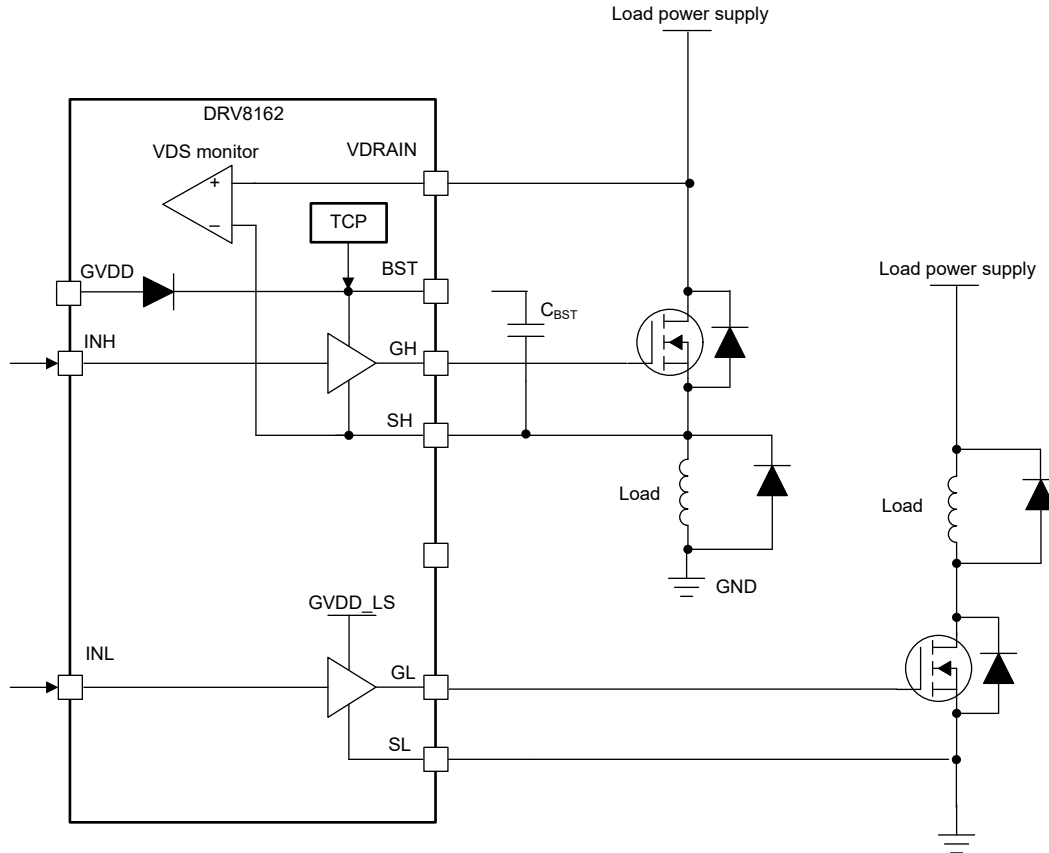


図 7-4. ハイサイドとローサイドの独立負荷に対応する独立 PWM モード

7.3.1.2 ゲート ドライブ アーキテクチャ

本ドライバ デバイスは、ハイサイドとローサイド両方のドライバに対して、相補型のプッシュプルトポロジが使用されています。このトポロジにより、外部 MOSFET ゲートのプルアップとプルダウンが両方とも強化できます。ローサイド ゲートドライバには、GVDD レギュレータ電源から直接電力が供給されます。ハイサイド ゲートドライバ用には、ブートストラップ ダイオードとブートストラップ コンデンサを使ってフローティング ハイサイド ゲート電源電圧を生成します。ブートストラップ ダイオードは内蔵されており、BST ピンに外付けのブートストラップ コンデンサを使います。

電源が切り離された際に外部 MOSFET がターンオンするのを防止するため、ハイサイド ゲートドライバはセミアクティブプルダウンを備えており、ローサイド ゲートはパッシブプルダウンを備えています。

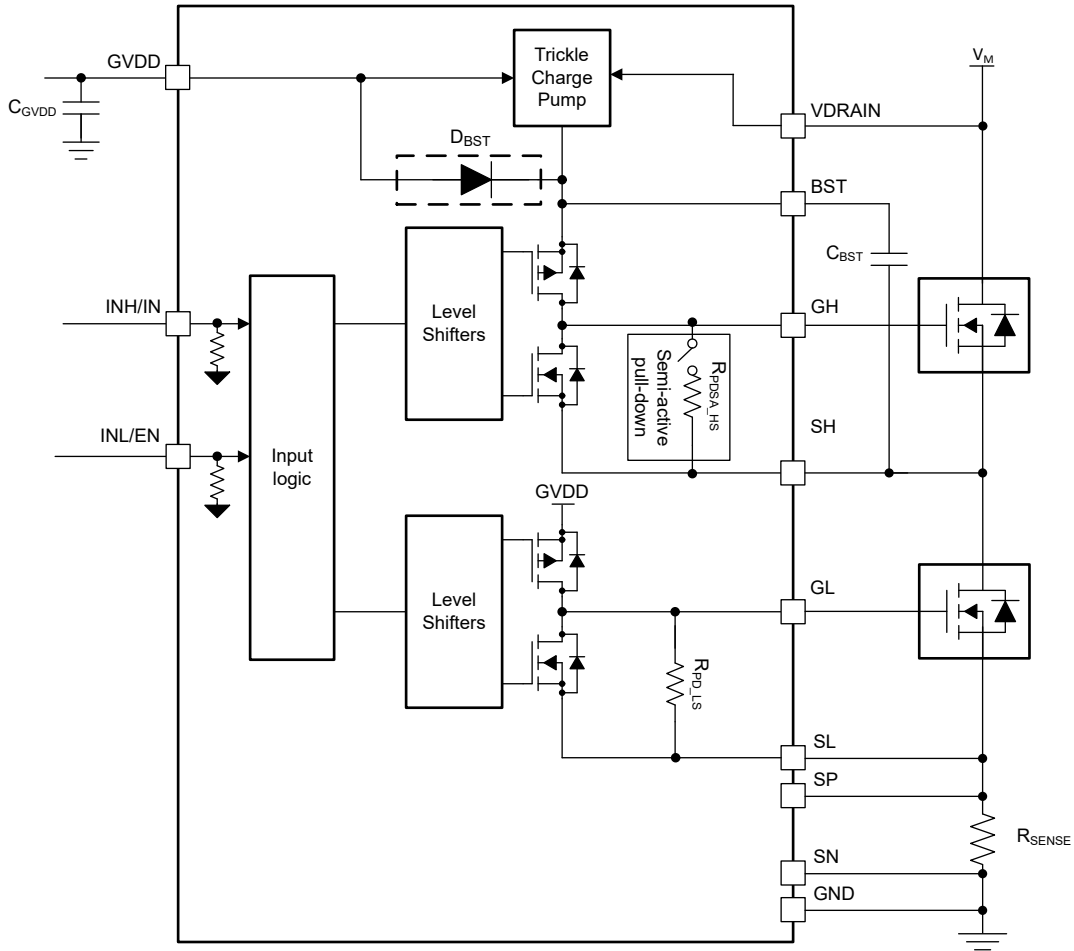


図 7-5. DRV8161 ゲート ドライバ ブロック

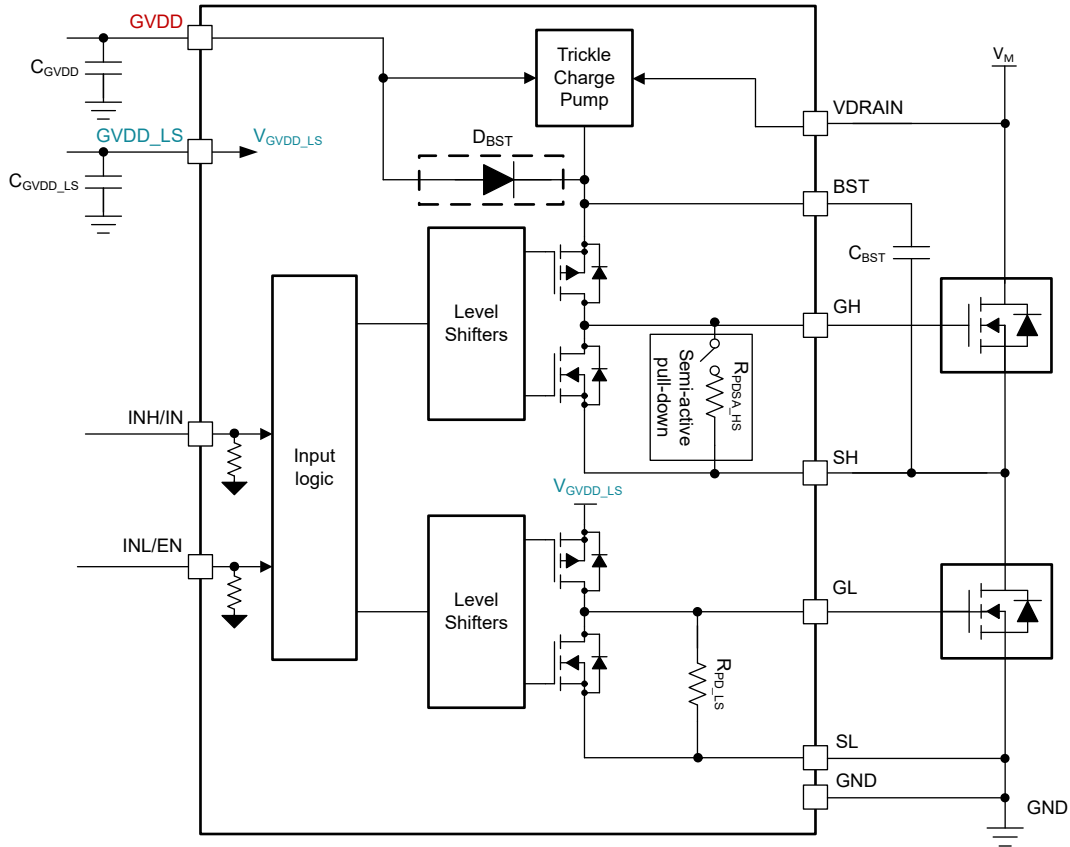


図 7-6. DRV8162 および DRV8162L ゲートドライバのブロック図

7.3.1.2.1 ティックルチャージポンプ (TCP)

ドライバと外部コンポーネントのリーク電流による電圧降下を防止するため、トリクルチャージポンプ (TCP) が BST ノードに接続されています。チャージポンプは、VDRAIN ピンを基準にして V_{TCP} 電圧を生成します。独立 PWM モードでは、チャージポンプは常時アクティブです。2 ピン PWM および 1 ピン PWM モードで、INL が 250us (標準値) にわたって Low のままである場合、チャージポンプがアクティブになります。

7.3.1.2.2 デッドタイムとクロス導通防止 (貫通電流保護)

DRV816x はデッドタイム挿入機能を備えており、各ハーフブリッジの外部 MOSFET の両方が同時にオンに切り替わるのを防止します。デッドタイムは、DT/MODE とグラウンドの間に抵抗を接続することで、20ns~900ns の範囲で有効化および調整できます。セクション 7.3.2.6 を参照してください。

DRV816x では、デバイスが 2 ピン PWM モードに構成されている場合、ハイサイド入力とローサイド入力は独立して動作しますが、同じハーフブリッジのハイサイドとローサイドが同時にオンになっている場合、クロス導通を防止するための例外があります。このデバイスは、ハイサイドとローサイドの入力が同時にロジックハイになった場合に貫通電流を防止するために、ハイサイドとローサイドの出力が OFF になります。

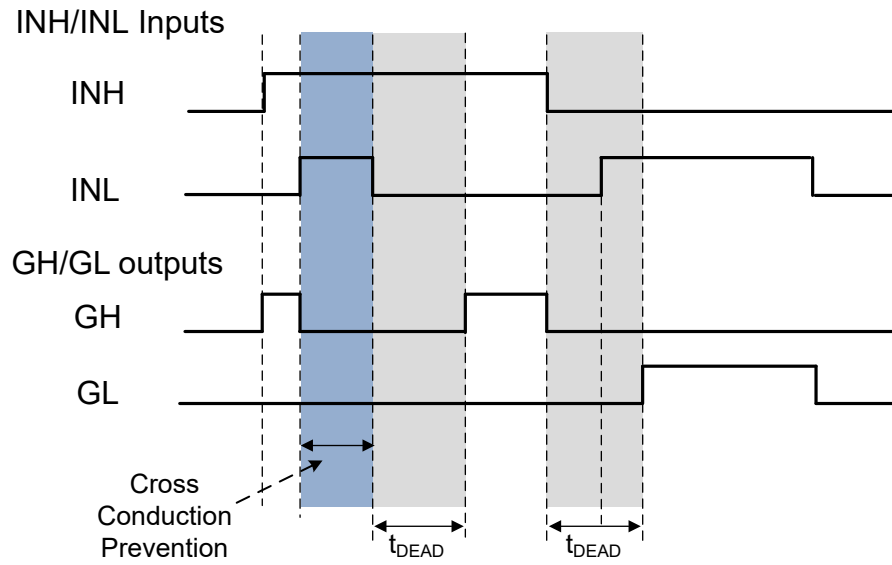


図 7-7. クロス導通防止とデッドタイム挿入 (2 ピン PWM、デッドタイム挿入有効)

7.3.2 ピン配置図

7.3.2.1 4 レベル入力ピン (CSAGAIN)

図 7-8 は、ハードウェアインターフェース構成用の 4 レベル入力ピン CSAGAIN の構造を示しています。入力は外付け抵抗で設定できます。C_{CSAGAIN} は、GND ノイズの影響を低減するためのオプションです。CSA ゲイン情報は、デバイスの電源投入時にラッチされず、デバイス動作中に更新できます。

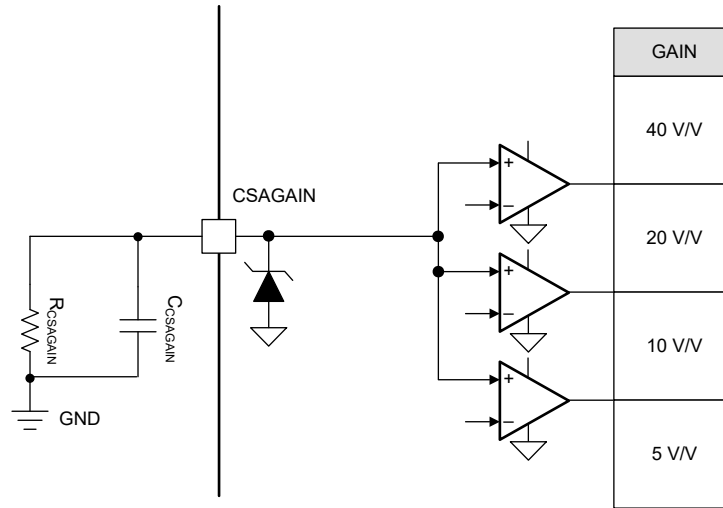


図 7-8. 4 レベル入力ピンの構造

7.3.2.2 デジタル出力 nFAULT (DRV8162、DRV8162L)

図 7-9 は、オープンドレイン出力ピンである nFAULT の構造を示しています。オープンドレイン出力を正しく機能させるためには、外部プルアップ抵抗が必要です。nFAULT を含むデバイスのアクションについては、を参照して表 7-7 ください。

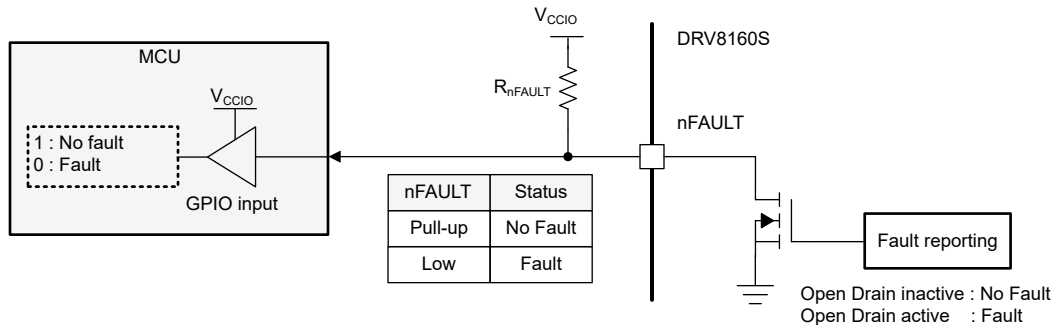


図 7-9. nFAULT オープンドレイン出力バッファ

7.3.2.3 デジタル入力/出力 nFAULT/nDRVOFF (DRV8161)

図 7-10 は、オープンドレイン出力ピンの構造を示しています。DRV8161 デバイス バリエーションでは、1 つのデバイスピン nFAULT/nDRVOFF を共有することで、2 つの機能 nFAULT と nDRVOFF が実現されます。オープンドレイン出力を正しく機能させるためには、外部プルアップ抵抗が必要です。故障状態が検出されると、デバイスはオープンドレインバッファを起動し、nFAULT/nDRVOFF ピンが low に駆動されます。nFAULT/nDRVOFF ピンは、ゲートドライブシャットダウンロジックに内部接続されており、nFAULT/nDRVOFF ピンがローレベルの場合、ゲートドライブ出力はシャットダウン(プルダウン)されます。nFAULT を含むデバイスのアクションについては、を参照して表 7-7 ください。

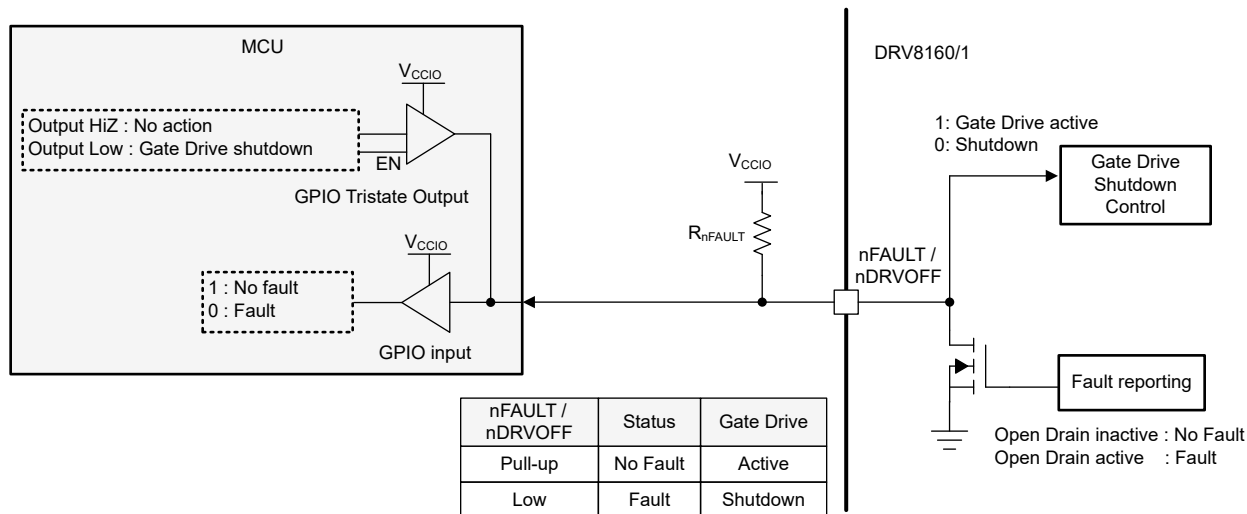


図 7-10. nFAULT/nDRVOFF オープンドレイン出力および入力バッファ

7.3.2.4 マルチレベル入力 (IDRIVE1 および IDRIVE2)

DRV816x にはゲート駆動電流を設定するための IDRIVE1 および IDRIVE2 デバイスピンがあります。各ピンは、デバイスのピンと GND の間に外付け抵抗を接続し LEVEL0~LEVEL7 の 8 つのレベルに設定できます。ゲート駆動電流 I_{DRIVEN} と I_{DRIVEP} は表 7-4 で定義できます。表の (g) は、VGS モニタのデッドタイム挿入が無効であることを示しています。IDRIVE1 および IDRIVE2 の情報は、デバイスの電源オン時にラッチされます。

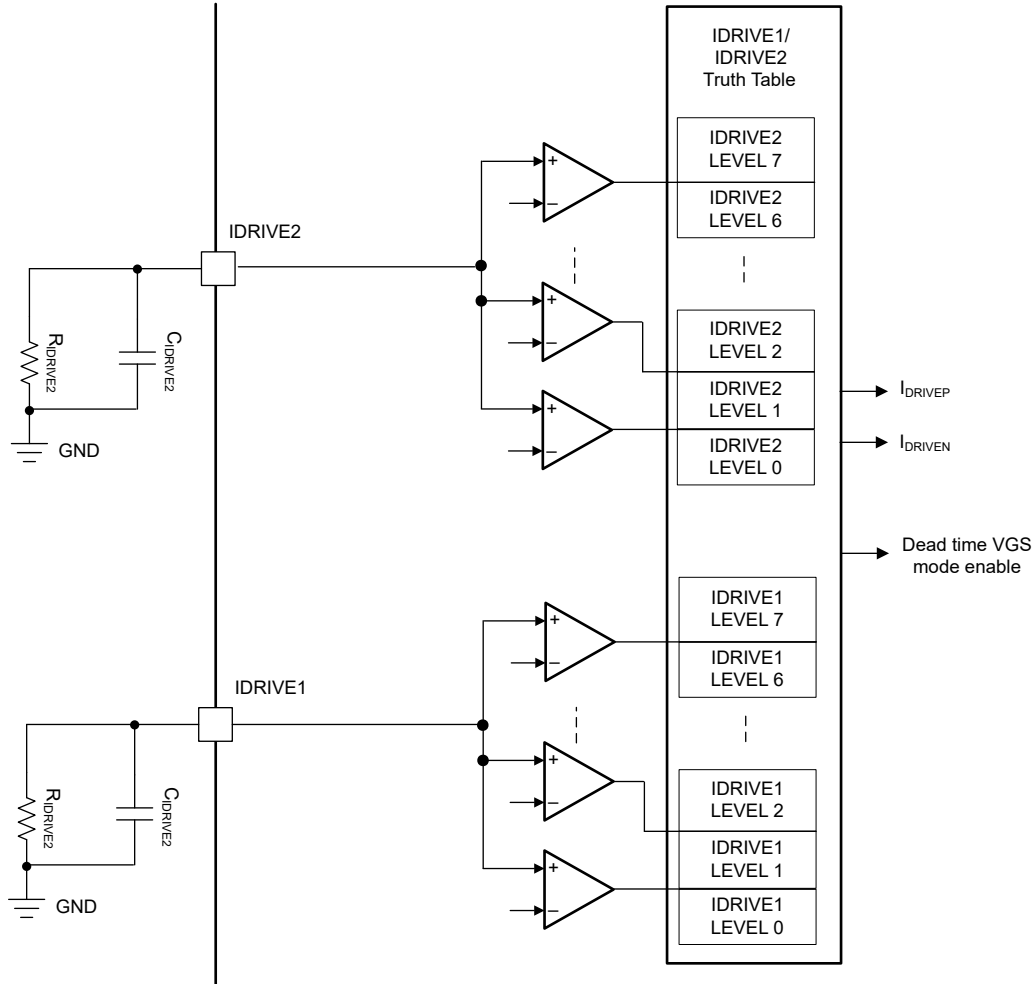


図 7-11. IDRIVE1 および IDRIVE2 のマルチレベルデジタル入力

表 7-4. ゲート駆動電流構成の IDRIVE1>IDRIVE2 真理値表

		IDRIVE2 入力ピン (R _{IDRIVE2})															
		LEVEL0 (GND への短絡)		LEVEL1 (2KΩ、代表値)		LEVEL2 (5.6KΩ、代表値)		LEVEL3 (12KΩ、代表値)		LEVEL4 (27KΩ、代表値)		LEVEL5 (62KΩ、代表値)		LEVEL6 (130KΩ、代表値)		LEVEL7 (オープン)	
		ソース:シンク=1:2		ソース:シンク=1:2		ソース:シンク=1:1.5		ソース:シンク=1:1.5		ソース:シンク=1:1		ソース:シンク=1:3		VGS デッドタイム挿入が有効		IDRIVE2 オープン	
		I _{DRIVE P} [mA]	I _{DRIVE N} [mA]	I _{DRIVE P} [mA]	I _{DRIVE N} [mA]	I _{DRIVE P} [mA]	I _{DRIVE N} [mA]	I _{DRIVE P} [mA]	I _{DRIVE N} [mA]	I _{DRIVE P} [mA]	I _{DRIVE N} [mA]	I _{DRIVE P} [mA]	I _{DRIVE N} [mA]	I _{DRIVE P} [mA]	I _{DRIVE N} [mA]	I _{DRIVE P} [mA]	I _{DRIVE N} [mA]
IDRIVE1 入力ピン (R _{IDRIVE1})	LEVE L7 (オープン)	256	512	16	32	256	384	16	32	128	128	64	192	32 (G)	64 (G)	16 (G)	32 (G)
	LEVE L6 (130KΩ、代表値)	288	576	32	64	288	448	32	32	192	192	128	384	96 (G)	192 (G)	64 (G)	128 (G)
	LEVE L5 (62KΩ、代表値)	320	640	64	128	320	448	64	64	256	256	192	576	128 (G)	256 (G)	128	256
	LEVE L4 (27KΩ、代表値)	384	768	96	192	384	576	96	128	320	320	256	768	160 (G)	320 (G)	192	384
	LEVE L3 (12KΩ、代表値)	448	896	128	256	448	640	128	192	384	384	288	896	192 (G)	384 (G)	256	512
	LEVE L2 (5.6KΩ、代表値)	512	1024	160	320	512	768	160	256	448	448	384	1024	224 (G)	448 (G)	320	640
	LEVE L1 (2KΩ、代表値)	768	1536	192	384	768	1024	192	256	512	512	512	1536	512 (G)	1024 (G)	512	1024
	LEVE L0 (GND への短絡)	1024	2048	224	448	1024	1536	224	384	1024	1024	768	2048	1024 (G)	2048 (G)	1024	2048

7.3.2.5 マルチレベルデジタル入力 (VDSLVL)

DRV816x の VDS 監視スレッショルドレベルは、VDSLVL ピンを使用して構成できます。ピンは、VDSLVL と GND の間に外部抵抗を接続することで LEVEL0 から LEVEL7 までの 8 レベルを設定できます。7 つのスレッショルドレベルは、表 7-5 によって決定されます。図 7-13 に示すように、VDSLVL ピンにデジタルパルスをもつ印加すると、追加の 6 スレッショルドレベルが利用可能になります。VDSLVL ピンがオープンの場合、VDS 監視機能は無効化されます。VDS 監視スレッショルドの情報は、デバイスの電源オン時にラッチされます。

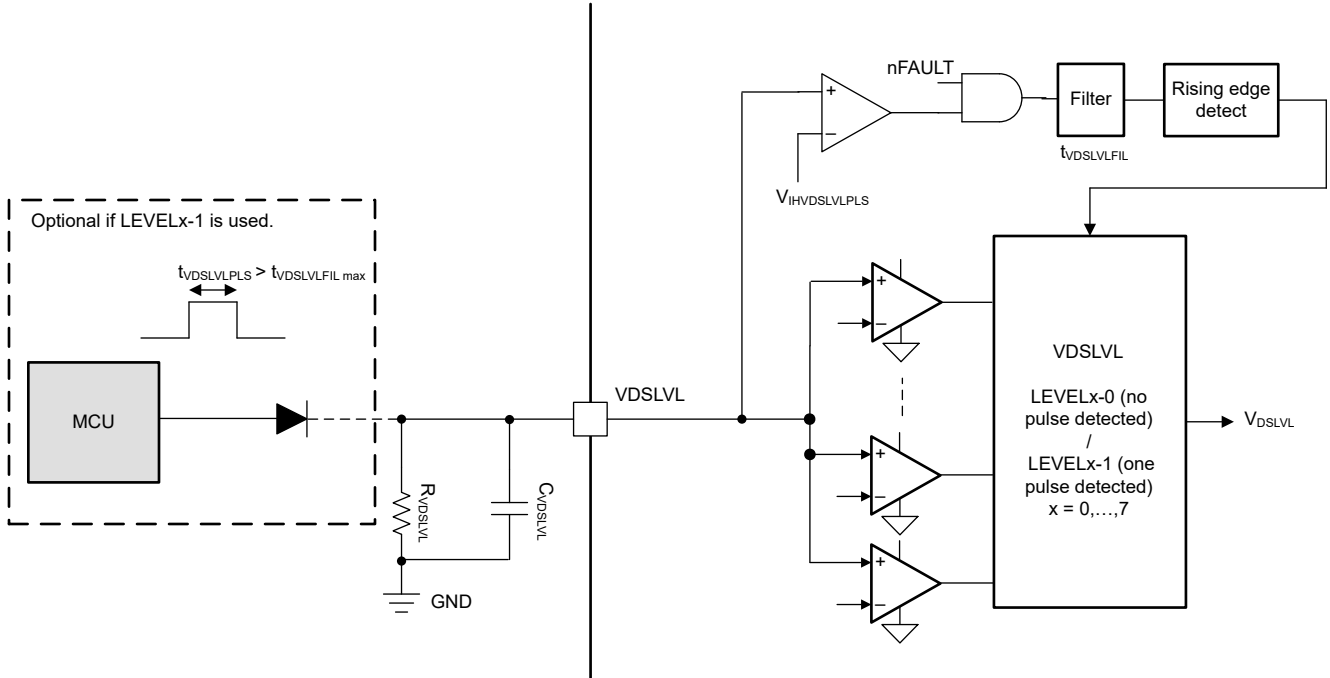


図 7-12. VDSLVL 入力パルスのタイミング図

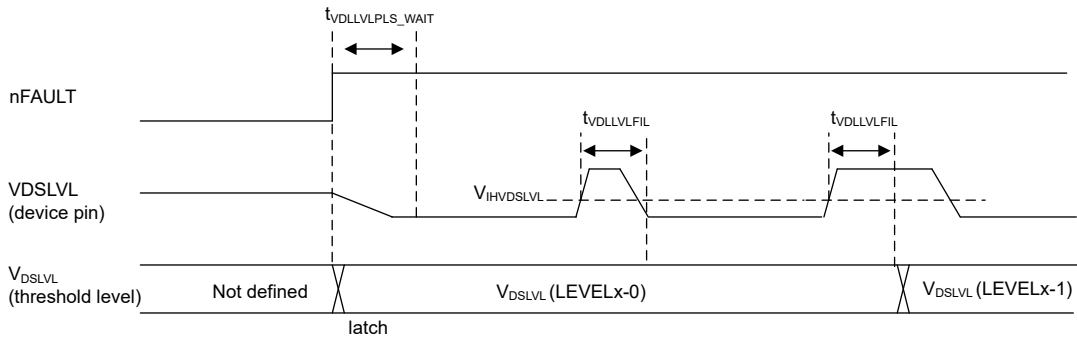


図 7-13. VDSLVL のマルチレベルデジタル入力

表 7-5. VDS スレッシュホールドレベル選択表

VDSLVL 入力ピン(R_{VDSLVL})	VDS 監視スレッシュホールド	
	LEVELx-0 (パルス検出なし)	LEVELx-1 (1つのパルスを検出)
LEVEL7 (OPEN)	ディセーブル	ディセーブル
LEVEL6 (130K Ω , 代表値)	2V	1.5V
LEVEL5 (62K Ω , 代表値)	1V	0.9V
LEVEL4 (27K Ω , 代表値)	0.8V	0.7V
LEVEL3 (12K Ω , 代表値)	0.6V	0.5V
LEVEL2 (5.6K Ω , 代表値)	0.4V	0.3V
LEVEL1 (2K Ω , 代表値)	0.2V	0.15V
LEVEL0 (GND への短絡)	0.1V	該当なし

7.3.2.6 マルチレベルデジタル入力 DT/MODE

図 7-14 は、ハードウェアインターフェイス構成におけるマルチレベル入力ピン DT/MODE の構造を示しています。入力には、GND に接続された外付け抵抗 R_{DTMODE} で設定できます。 C_{DTMODE} は、GND ノイズの影響を低減するためのオプションです。表 7-6 に示すように、貫流電流機能、デッドタイム挿入、および PWM 制御モードが設定されています。LEVEL0、1、2、3、LEVEL5 の情報は、デバイスの電源オン時にラッチされます。

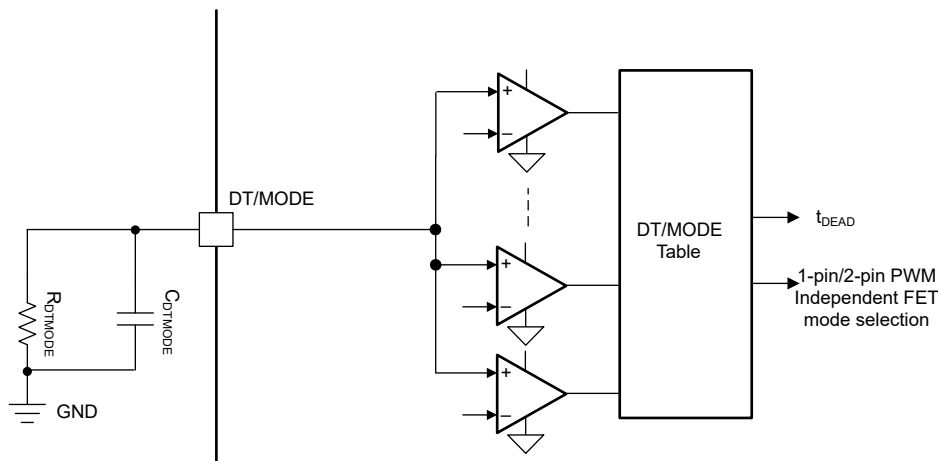


図 7-14. DT/MODE ピンの構造

表 7-6. DT/MODE 表

DT/ MODE (R_{DTMODE})	貫通電流保護	デッドタイムの挿入 (t_{DEAD})	PWM 制御モード
LEVEL5 (ピンがフローティング、> 3.3M Ω)	有効	無効。IDRIVE により VGS デッドタイム挿入が有効にされている場合、 $t_{MINDEAD_VG}$ が挿入されます	2 ピン PWM
LEVEL4 -リニア (10K Ω ~1M Ω)	有効	有効 (20ns~900ns)	1 ピン PWM
LEVEL3 (3.3K Ω)	有効	有効 (370ns)	2 ピン PWM
LEVEL2 (1.3K Ω)	有効	有効 (100ns)	2 ピン PWM
LEVEL1 (470 Ω)	有効	有効 (20ns)	2 ピン PWM
LEVEL0 (GND への短絡)	ディセーブル	ディセーブル	独立した PWM

式 1 を使用して、LEVEL4 のデッドタイムを計算します。

$$t_{dead}(ns) = 0.89 \times R_{DTMODE}(k\Omega) + 11.1 \quad (1)$$

7.3.3 ローサイド電流検出アンプ

DRV8161 は、ローサイド シャント抵抗を使った電流測定のための高性能ローサイド電流検出アンプを内蔵しています。ローサイド電流測定は、一般に過電流保護、外部トルク制御、または外部コントローラによるブラシレス DC の整流を実装するために使用されます。電流センスアンプを使用して、ハーフブリッジ電流の合計を検出できます。電流センスアンプには、構成可能なゲイン、電圧リファレンスピン (CSAREF) などの機能が含まれています。DRV8161 は、 $V_{CSAREF}/2$ の共通電圧を内部で生成します。

ゲイン設定は 4 つの異なるレベル (5V/V、10V/V、20V/V、40V/V) に調整できます。ゲイン設定は、CSAGAIN ピンを使用して構成できます。

7.3.3.1 双方向電流検出の動作

DRV8161 は、電流測定を双方向で行うために、コモンモード電圧を内部で生成します。電流センスアンプは双方向モードとして動作し、SO ピンは、SP および SN ピン間の電圧にゲイン設定 (G_{CSA}) と出力バイアス電圧 $V_{VREF} / 2$ を乗算した値に等しいアナログ電圧を出力します。

シャント抵抗 ($CSAREF / 2$ case) を流れる電流値を計算するには、式 2 を使用します。

$$I = \frac{V_{SOx} - \frac{V_{VREF}}{2}}{G_{CSA} \times R_{SENSE}} \quad (2)$$

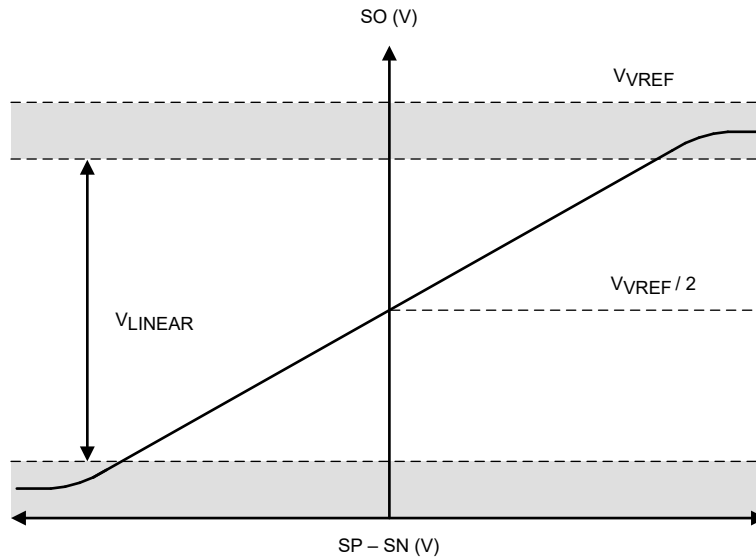


図 7-15. 双方向電流検出の出力

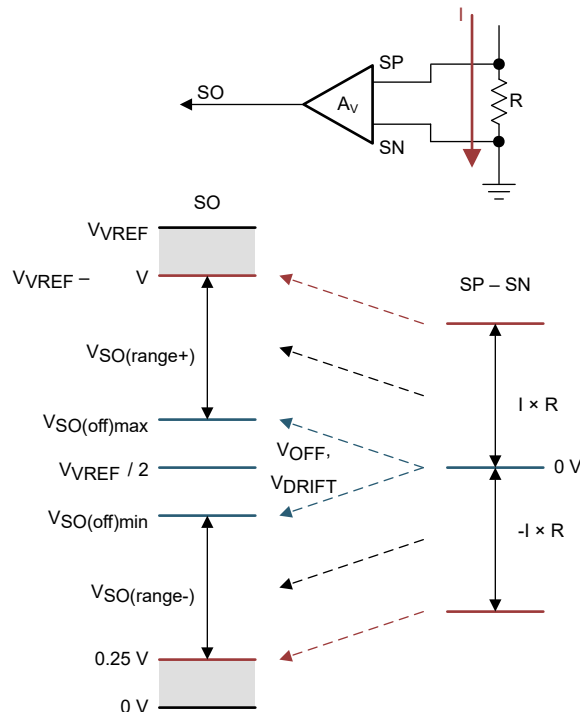


図 7-16. 双方向電流検出の領域

7.3.4 ゲートドライバシャットダウンシーケンス (nDRVOFF)

nDRVOFF が Low に駆動されると、ゲートドライバはシャットダウンに移行し、入力ピン INH/IN および INL/EN の信号がオーバーライドされます。nDRVOFF はデバイス内部のデジタル制御ロジックをバイパスし、ゲートドライバ出力に直接接続されます。このピンを使うと、内部制御ロジックを直接バイパスできるため、ゲートドライバが無効化された際の故障を外部から監視できます。DRV816x が nDRVOFF ピンを LOW に駆動していることを検出すると、デバイスはゲートドライバを無効にし、ゲートドライバをプルダウンモードに移行します。ゲートドライバのシャットダウンシーケンスは、[図 7-17](#) に示すように進行します。ゲートドライバがシャットダウンシーケンスを開始すると、ドライバプルダウンが I_{DRVN_SD} の電流で t_{DRVN_SD} 時間の間アクティブプルダウンが適用されます。

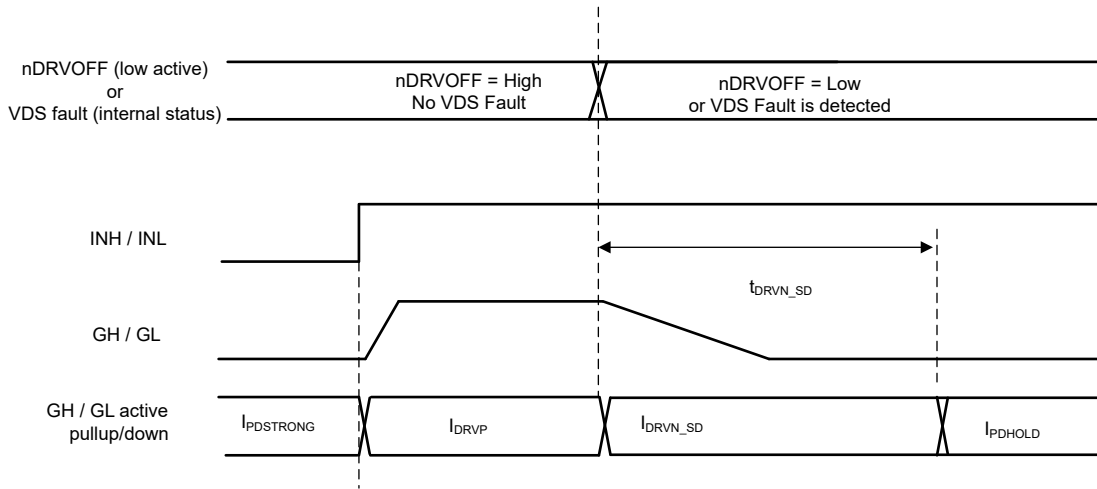


図 7-17. ゲートドライバシャットダウンシーケンス

7.3.4.1 nDRVOFF 診断

[図 7-18](#) は DRV8162 および DRV8162L の nDRVOFF の診断を推奨します。nDRVOFF ピンに Low アクティブパルス $t_{nDRVOFF_DIAG}$ (標準値 0.5us) が印加された場合、デバイスはゲートドライバ出力をシャットダウンせず、nFAULT を Low に駆動することにより応答します。このデバイス機能は、PWM 動作を継続しながら nDRVOFF の機能を診断することを目的としています。nDRVOFF が $t_{nDRVOFF_DEG}$ よりも長い間 Low に駆動されると、デバイスはシャットダウンを開始します。

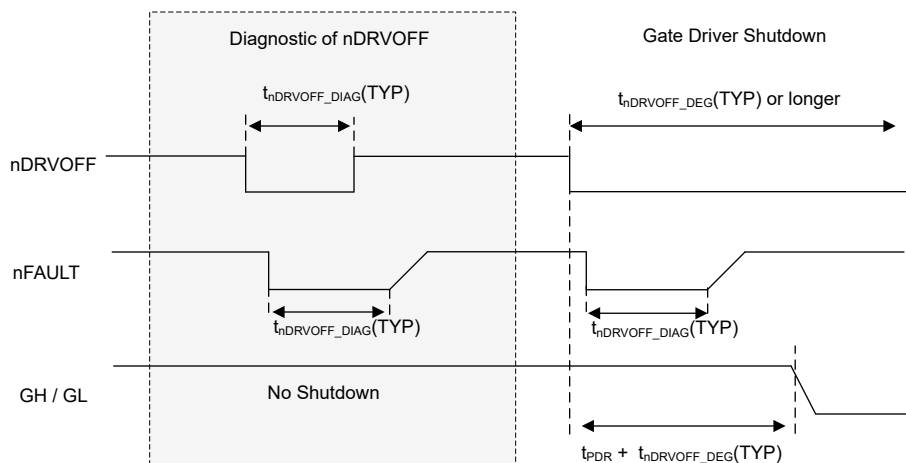


図 7-18. nDRVOFF 診断

7.3.5 ゲートドライバ保護回路

DRV816x は、GVDD 低電圧および過電圧、ブートストラップ低電圧、MOSFET V_{DS} および過熱 (OTSD) イベントから保護されています。

表 7-7. フォルト動作および応答

フォルト	条件	構成	通知	ゲートドライバ GH	ゲートドライバ GL	復帰
GVDD 低電圧 (GVDD_UV)	$V_{GVDD} < V_{GVDD_UV}$	-	nFAULT	S-PD ⁽¹⁾	P-PD ⁽²⁾	$V_{GVDD} > V_{GVDD_UV}$
V_{DS} 過電流 (VDS_OCP)	$V_{DS} > V_{DSSLV}$	R 付き VDSLVL ピン (LEVEL0~LEVEL6)	nFAULT	S-PD ⁽¹⁾	P-PD ⁽²⁾	ラッチ: INH (IN) = Low & INL (EN) = Low > t_{CLRFLT} 用
		VDSLVL ピンオープン (LEVEL7)	なし	アクティブ ⁽³⁾	アクティブ ⁽³⁾	何も起こらない
サーマル シャットダウン (OTSD)	$T_J > T_{OTSD}$	-	nFAULT	S-PD ⁽¹⁾	P-PD ⁽²⁾	$T_J < T_{OTSD}$
ブートストラップ低電圧	$V_{BST-SH} < V_{BST_UV}$	-	なし	S-PD ⁽¹⁾	アクティブ ⁽³⁾	$V_{BST-SH} > V_{BST_UV}$

- (1) S-PD: セミアクティブ プルダウン
- (2) P-PD: パッシブプルダウン
- (3) アクティブ: PWM ではゲートドライバがアクティブになります

7.3.5.1 GVDD 低電圧誤動作防止 (GVDD_UV)

GVDD ピンの電圧が V_{GVDD_UV} スレッシュホールドを下回る状態が、 $t_{GVDD_UV_DG}$ デグリッチ時間を超えると常に、本デバイスは GVDD 低電圧イベントを検出します。GVDD_UV 低電圧イベントの検出後、外部 MOSFET をオフにするため、すべてのゲートドライバ出力は Low に駆動され、チャージポンプは無効になり、nFAULT ピンは Low に引き下げられます。GVDD_UV 条件がクリアされると、nFAULT は High になります。

7.3.5.2 MOSFET V_{DS} 過電流保護 (VDS_OCP)

DRV816x デバイスには、外部パワー MOSFET での過電流状態や短絡状態を検出するために、調整可能な V_{DS} 電圧監視が実装されています。MOSFET 過電流状態は、外部 MOSFET $R_{DS(on)}$ での V_{DS} 電圧降下を監視することによって検出されます。ハイサイド VDS 監視は VDRAIN ピンと SH ピンの間の電圧が測定されます。ローサイド VDS 監視では SH ピンと SL ピンの間の電圧が測定されます。外部 MOSFET にかかる電圧が、 V_{DSSLV} スレッシュホールドを t_{DS_DG} グリッチ除去時間より上回ると、VDS_OCP イベントが認識されます。VDS 過電流イベントの検出後、外部 MOSFET をオフにするため、すべてのゲートドライバ出力は Low に駆動され、nFAULT ピンは Low に駆動されます。VDS スレッシュホールドは、VDSLVL ピンによって 0.1V~2.0V の範囲で設定できます。VDS グリッチ除去時間は t_{DS_DG} に固定されています。VDS OCP は、VDSLVL ピンをオープンにすることで無効化できます。過電流状態が解消された後、故障状態はラッチされたままとなり、INH (IN) と INL (EN) が t_{CLRFLT} 時間の間 low を維持すると、クリアされます。

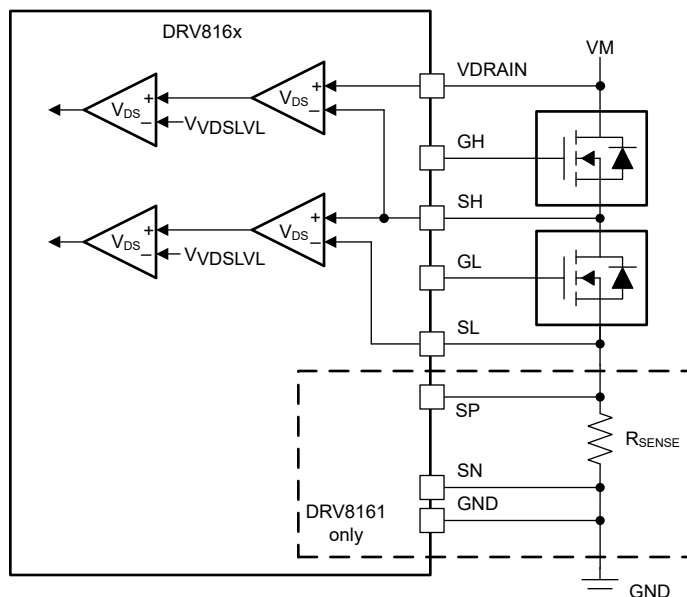


図 7-19. DRV816x MOSFET V_{DS} 過電流保護

7.3.5.3 サーマル シャットダウン (OTSD)

ダイ温度がサーマル シャットダウン制限のトリップ ポイント (T_{OTSD}) を超えると、OTSD イベントが認識されます。OTSD 過熱イベントの検出後、外部 MOSFET をオフにするため、すべてのゲートドライバ出力は Low に駆動され、nFAULT ピンは Low に駆動されます。OTSD 状態がクリアになると、デバイスは通常動作に戻り、nFAULT は High になります。

8 アプリケーションと実装

注

以下のアプリケーション情報は、テキサス・インスツルメンツの製品仕様に含まれるものではなく、テキサス・インスツルメンツはその正確性も完全性も保証いたしません。個々の目的に対する製品の適合性については、お客様の責任で判断していただくことになります。お客様は自身の設計実装を検証しテストすることで、システムの機能を確認する必要があります。

8.1 アプリケーション情報

DRV816x ファミリのデバイスは、主に 3 相ブラシレス DC モーター制御のアプリケーションで使用されます。「[セクション 8.2](#)」セクションの設計手順では、DRV816x ファミリのデバイスの使用方法与設定方法を中心に説明します。

8.2 代表的なアプリケーション

8.2.1 DRV8161 の代表的なアプリケーション

図は DRV8161 の代表的なアプリケーション図を示しています。

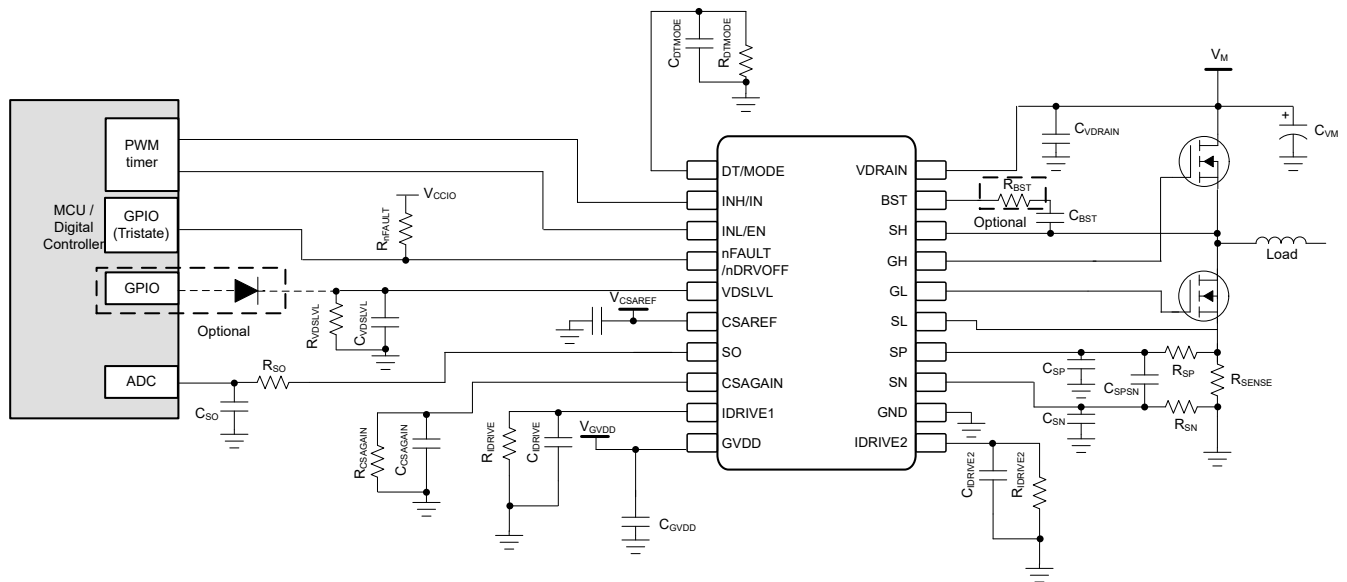


図 8-1. DRV8161 の代表的なアプリケーション図

8.2.2 DRV8162 と DRV8162L を使用した代表的なアプリケーション

図は DRV8162 と DRV8162L の代表的なアプリケーション図を示しています。

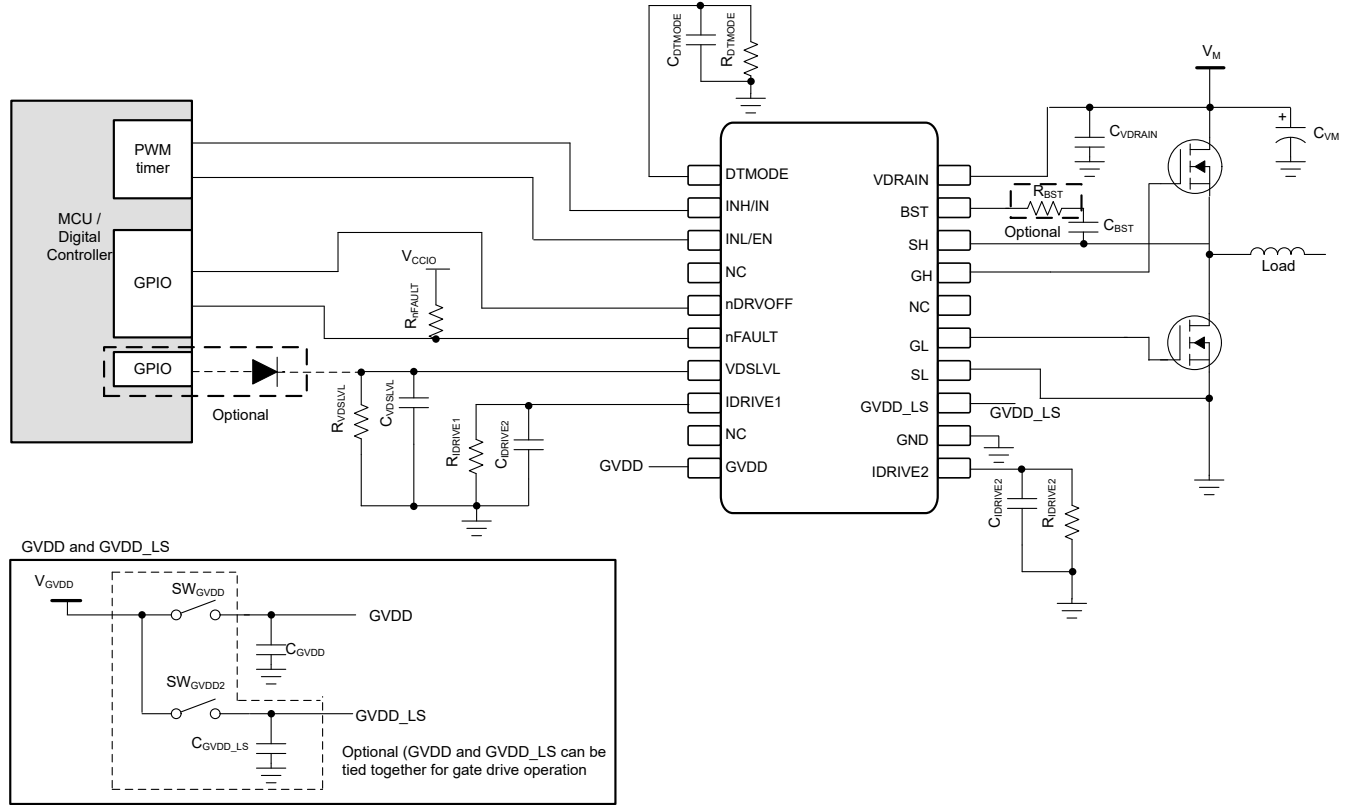


図 8-2. DRV8162 と DRV8162L の代表的なアプリケーション図

8.2.3 外付け部品

表は、ゲートドライバの外部コンポーネントの推奨値を記載しています。

表 8-1. DRV816x の外付け部品

部品	ピン 1	ピン 2	推奨
C _{BST}	BST	SH	1.0μF、外部 MOSFET の Q _g のゲート電荷量の合計に応じて BST と SH の間に V _{BST-SH} 定格のコンデンサを配置します。C _{BST} > 20 X Q _g / (V _{GH} - V _{SH})。最大 C _{BST} は 2.2μF です。
C _{GVDD}	GVDD	GND	10μF、V _{GVDD} 定格コンデンサ。このコンデンサは、3 相パワー段設計において、コンデンサを 3 つのデバイスすべてに十分に近づけて配置すれば、他の 2 つの DRV816x デバイスと共有することができます。起動時および PWM スwitchング時のブートストラップ動作による電圧降下については、ユーザーによる確認が必要です。
C _{GVDD_LS}	GVDD_LS	GND	1μF、V _{GVDD} 定格コンデンサ
C _{VDRRAIN}	VDRRAIN	GND	0.1μF、V _{VDRRAIN} 定格コンデンサ
R _{nFAULT}	V _{CCIO}	nFAULT	プルアップ抵抗 10K Ω
R _{IDRIVE1}	IDRIVE1	GND	ハードウェアインターフェイス抵抗器については、 セクション 7.3.2.4 を参照してください
C _{IDRIVE1}	IDRIVE1	GND	オプション: 0.1nF、5V 定格コンデンサ
R _{IDRIVE2}	IDRIVE2	GND	ハードウェアインターフェイス抵抗器については、 セクション 7.3.2.4 を参照してください
C _{IDRIVE2}	IDRIVE2	GND	オプション: 0.1nF、5V 定格コンデンサ

表 8-1. DRV816x の外付け部品 (続き)

部品	ピン 1	ピン 2	推奨
R _{VDSLVL}	VDSLVL	GND	ハードウェアインターフェイス抵抗器については、 セクション 7.3.2.5 を参照してください
C _{VDSLVL}	VDSLVL	GND	オプション: 0.1nF、5V 定格コンデンサ
D _{VDSLVL}	VDSLVL	MCU	オプション: VDSLVL ピンと MCU GPIO の間のダイオード。
R _{DTMODE}	DT/ MODE	GND	ハードウェアインターフェイス抵抗器については、 セクション 7.3.2.6 を参照してください
C _{DTMODE}	DT/ MODE	GND	オプション: 0.1nF、5V 定格コンデンサ
R _{CSAGAIN}	CSAGAIN	GND	ハードウェアインターフェイス抵抗器については、 セクション 7.3.2.1 を参照してください
C _{CSAGAIN}	CSAGAIN	GND	オプション: 0.1nF、5V 定格コンデンサ
C _{CSAREF}	CSAREF	GND	0.1μF、V _{CSAREF} 定格コンデンサ
R _{SENSE}	SP	SN	検出シャント抵抗
R _{SP} 、R _{SN}	SP / SN	R _{SENSE}	オプション: 電流センスアンプ入力フィルタ用 10Ω。
C _{SPSN}	SP	SN	オプション: 電流センスアンプ入力フィルタ用 1nF セラミックコンデンサ。
C _{SP} 、C _{SN}	SP / SN	GND	オプション: 電流センスアンプ入力フィルタ用 1nF セラミックコンデンサ。

8.3 レイアウト

8.3.1 レイアウトのガイドライン

- GH、SH、GL、SL の各パターンの長さと同インピーダンスを最小化します。寄生インダクタンスを最小化するため、できるだけ少数のビアを使用します。寄生抵抗を最小限に抑えるため、デバイスピンから離して配線した直後にこれらのトレース幅を広げることを推奨します。
- ブートストラップコンデンサ C_{BST} は、対応するピンの近くに配置します
- これらの GVDD コンデンサは、GVDD のピンの近くに配置します
- チャージポンプに安定したスイッチング電流を供給するために、VDRAIN コンデンサを VDRAIN ピンの近くに配置します。
- 外部 MOSFET 上の高電流パスをバイパスするために、追加のバルク容量が必要です。このバルク容量は、バルク容量が外部 MOSFET を通過する高電流パスの長さを最小化するように配置されています。接続用の金属パターンはできる限り幅広くし、PCB の層間を多数のビアで接続します。これらの手法により、インダクタンスが最小限に抑えられ、バルクコンデンサが高電流を伝達できるようになります。
- VDS を正確に検出するため、SL ピンを GND に直接接続しないで MOSFET ソースに接続します。
- DRV8161 のみ: SN/SP ピンは、センス抵抗からデバイスに並列に配線します。フィルタリング後のノイズ結合を最小限に抑えるため、デバイスのピンの近くにフィルタコンポーネントを配置します。最高の CSA 精度を実現するには、SN/SP が GND プレーンから離れていることを確認してください。CSAREF と GND の間にあるバイパスコンデンサは、デバイスピンに近づけて配置します。
- ハードウェアインターフェイス抵抗 R_{IDRIVE1}、R_{IDRIVE2}、R_{VDSLVL}、R_{DTMODE}、R_{CSAGAIN} は、デバイスのピンにできるだけ近づけて配置されます。
- 潜在的なノイズ源からノイズに敏感なデバイスの信号へのノイズ結合を低減するために、並列ルーティングを最小限に抑えます。ノイズに敏感な信号には、マルチレベルのハードウェアインターフェイスピン IDRIVE1、IDRIVE2、VDSLVL、DTMODE、CSAGAIN や、電流センスアンプの出力 SO が含まれます。

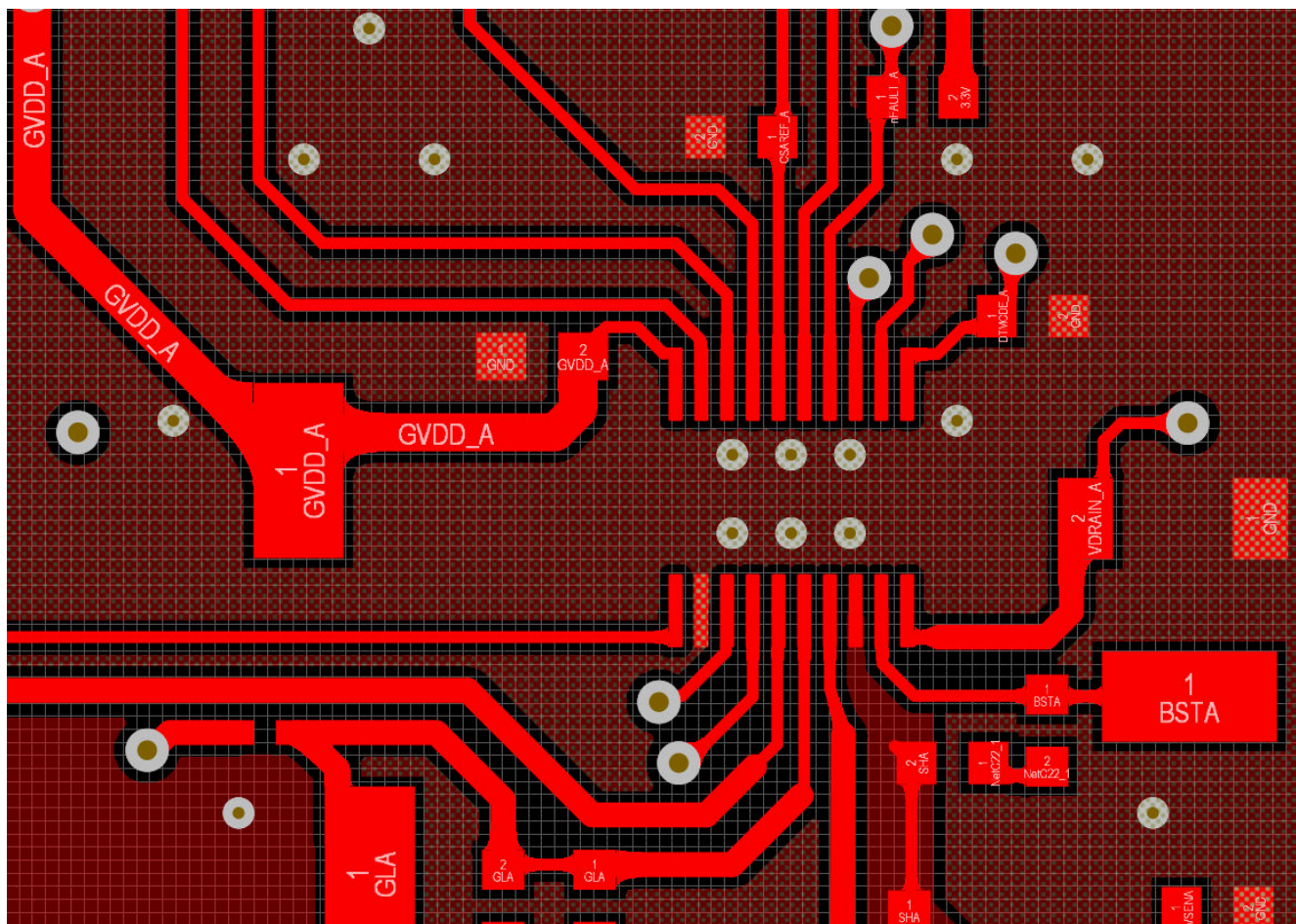


図 8-3. DRV8161 のレイアウト

8.4 電源に関する推奨事項

DRV816x ファミリーのデバイスは、5V~90V の入力電圧 (VDRAIN) で動作するように設計されています。VDRAIN 定格の 0.1 μ F セラミック コンデンサを デバイスのできるだけ近くに配置する必要があります。また、VDRAIN ピンにはバルク コンデンサを配置する必要がありますが、外部パワー MOSFET のバルク バイパス容量と共用可能です。外部のハーフブリッジ MOSFET をバイパスするために追加のバルク容量が必要となり、アプリケーションの要件に応じてサイズが決定されます。

8.4.1 バルク容量の決定

適切なローカル バルク容量の確保は、モーター駆動システム的设计において重要な要素です。一般に、バルク コンデンサが大きいほど利点がありますが、コストと物理的なサイズが増加します。ローカル容量値は、次のようなさまざまな要因で決まります。

- モーター システムが必要とする最大電流
- 電源タイプ、容量と電流供給能力
- 電源とモーター システムの間の寄生インダクタンスの大きさ
- 許容される電源電圧リップル
- モータの種類 (ブラシ付き DC、ブラシレス DC、ステッピング)
- モータの始動および制動方法

電源とモータードライブ システムの間のインダクタンスにより、電源からの電流が変化する速度が制限されます。ローカル バルク容量が小さすぎると、モーターに大電流を供給しようとする場合、または負荷ダンブが発生した場合、システムの電圧が変動します。十分なバルク容量を備えることで、モータの電圧は安定し、大電流を素早く供給できます。

データシートには推奨最小値が記載されていますが、バルク コンデンサの容量が適切かどうかを判断するには、システム レベルのテストが必要です。

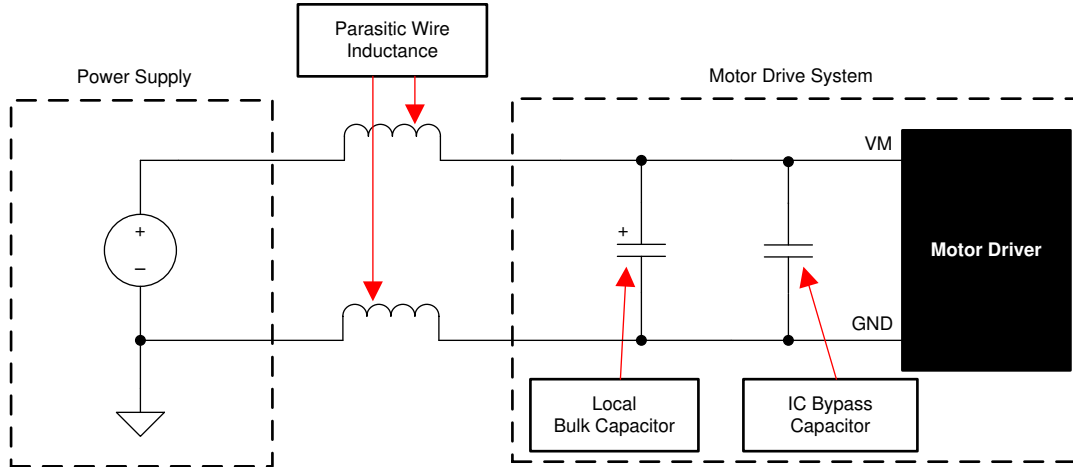


図 8-4. モータ駆動電源の寄生インダクタンスの例

9 デバイスおよびドキュメントのサポート

9.1 デバイス サポート

9.2 ドキュメントのサポート

9.2.1 関連資料

- テキサス・インスツルメンツ、『スマート ゲートドライブの理解 (Rev. D)』アプリケーション レポート
- テキサス・インスツルメンツ、『ブラシレス DC モータドライバの考慮事項および選択ガイド (Rev. A)』アプリケーション レポート
- テキサス・インスツルメンツ、『モータドライバの基板レイアウトのベスト プラクティス (Rev. B)』アプリケーション ノート
- テキサス・インスツルメンツ、『BLDC モータを使用する電動自転車のハードウェア設計の考慮事項』アプリケーション レポート
- テキサス・インスツルメンツ、『MSP430 を使用するセンサ付き 3 相 BLDC モータ制御』アプリケーション レポート

9.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法

ドキュメントの更新についての通知を受け取るには、www.tij.co.jp のデバイス製品フォルダを開いてください。[通知] をクリックして登録すると、変更されたすべての製品情報に関するダイジェストを毎週受け取ることができます。変更の詳細については、改訂されたドキュメントに含まれている改訂履歴をご覧ください。

9.4 サポート・リソース

テキサス・インスツルメンツ E2E™ サポート・フォーラムは、エンジニアが検証済みの回答と設計に関するヒントをエキスパートから迅速かつ直接得ることができる場所です。既存の回答を検索したり、独自の質問をしたりすることで、設計に必要な支援を迅速に得ることができます。

リンクされているコンテンツは、各寄稿者により「現状のまま」提供されるものです。これらはテキサス・インスツルメンツの仕様を構成するものではなく、必ずしもテキサス・インスツルメンツの見解を反映したものではありません。テキサス・インスツルメンツの使用条件を参照してください。

9.5 商標

テキサス・インスツルメンツ E2E™ is a trademark of Texas Instruments.

すべての商標は、それぞれの所有者に帰属します。

9.6 静電気放電に関する注意事項



この IC は、ESD によって破損する可能性があります。テキサス・インスツルメンツは、IC を取り扱う際には常に適切な注意を払うことを推奨します。正しい取り扱いおよび設置手順に従わない場合、デバイスを破損するおそれがあります。

ESD による破損は、わずかな性能低下からデバイスの完全な故障まで多岐にわたります。精密な IC の場合、パラメータがわずかに変化するだけで公表されている仕様から外れる可能性があるため、破損が発生しやすくなっています。

9.7 用語集

テキサス・インスツルメンツ用語集 この用語集には、用語や略語の一覧および定義が記載されています。

9.8 コミュニティ リソース

10 改訂履歴

資料番号末尾の英字は改訂を表しています。その改訂履歴は英語版に準じています。

Changes from Revision B (December 2024) to Revision C (February 2025)

Page

- DRV8162 と DRV8162L デバイスのステータスを「量産データ」に更新。..... 1

Changes from Revision A (July 2024) to Revision B (December 2024) **Page**

- DRV8161 を量産データに更新。 **1**
-

Changes from Revision * (May 2024) to Revision A (July 2024) **Page**

- DRV8162L のデバイス ステータスを「事前情報」に更新..... **1**
-

11 メカニカル、パッケージ、および注文情報

以降のページには、メカニカル、パッケージ、および注文に関する情報が記載されています。この情報は、指定のデバイスに使用できる最新のデータです。このデータは、予告なく、このドキュメントを改訂せずに変更される場合があります。本データシートのブラウザ版を使用されている場合は、画面左側の説明をご覧ください。

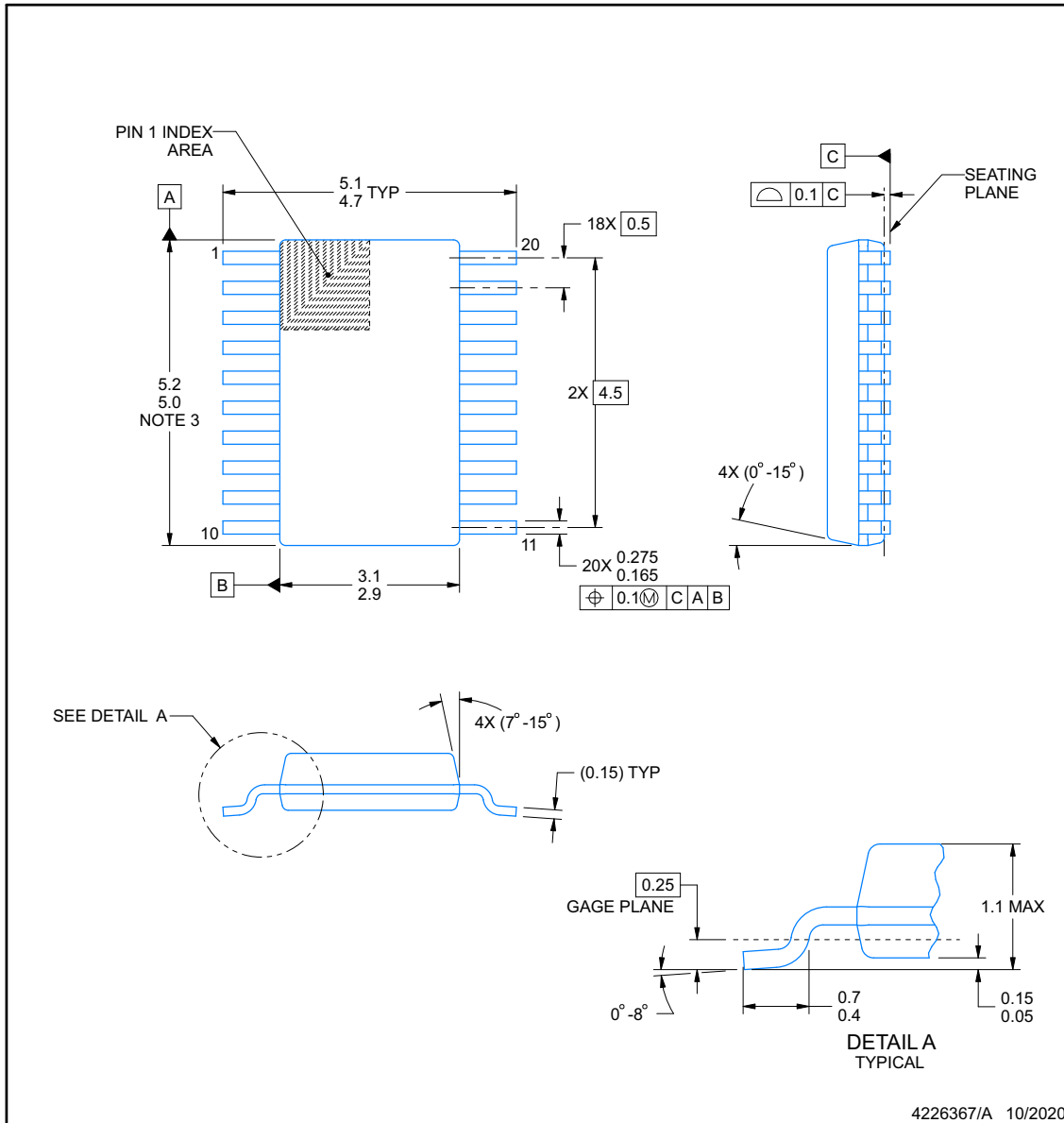


PACKAGE OUTLINE

DGS0020A

VSSOP - 1.1 mm max height

SMALL OUTLINE PACKAGE



NOTES:

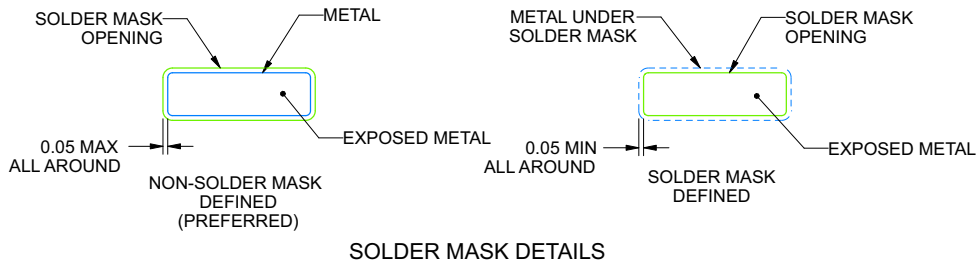
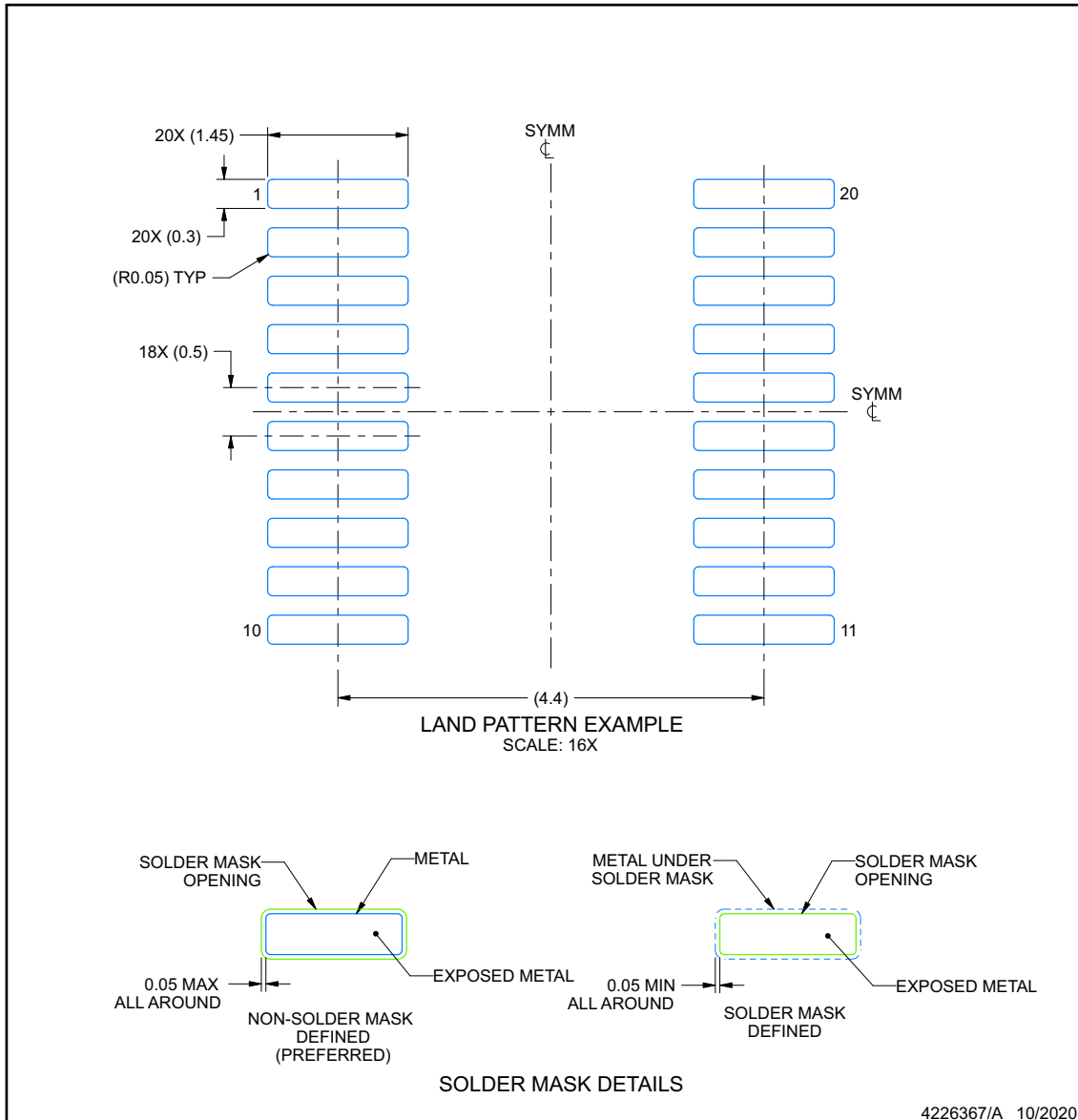
1. All linear dimensions are in millimeters. Any dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.
3. This dimension does not include mold flash, protrusions, or gate burrs. Mold flash, protrusions, or gate burrs shall not exceed 0.15 mm per side.
4. No JEDEC registration as of September 2020.
5. Features may differ or may not be present.

EXAMPLE BOARD LAYOUT

DGS0020A

VSSOP - 1.1 mm max height

SMALL OUTLINE PACKAGE



NOTES: (continued)

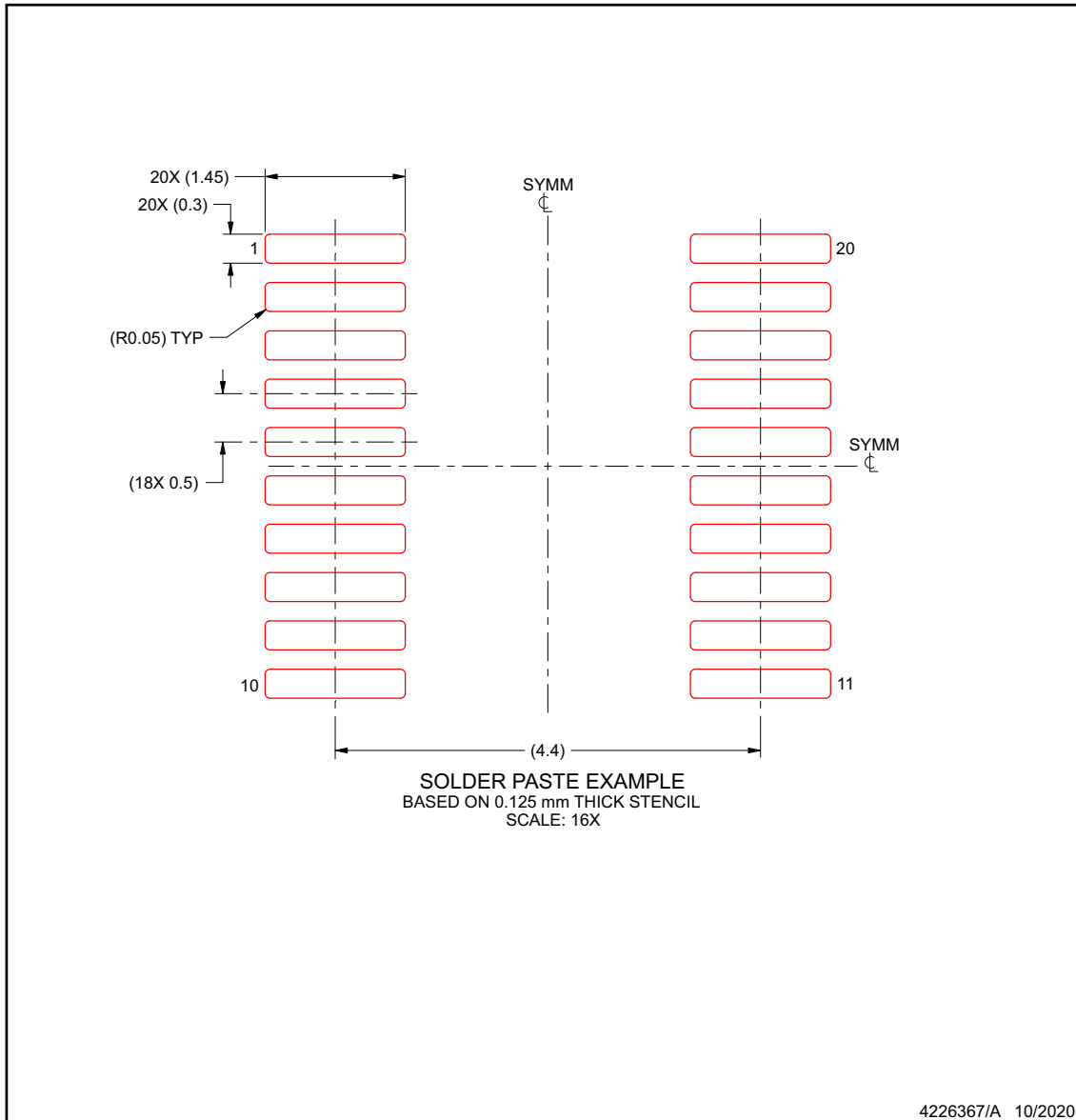
6. Publication IPC-7351 may have alternate designs.
7. Solder mask tolerances between and around signal pads can vary based on board fabrication site.
8. This package is designed to be soldered to a thermal pad on the board. For more information, see Texas Instruments literature numbers SLMA002 (www.ti.com/lit/slma002) and SLMA004 (www.ti.com/lit/slma004).
9. Size of metal pad may vary due to creepage requirement.
10. Vias are optional depending on application, refer to device data sheet. It is recommended that vias under paste be filled, plugged or tented.

EXAMPLE STENCIL DESIGN

DGS0020A

VSSOP - 1.1 mm max height

SMALL OUTLINE PACKAGE



NOTES: (continued)

- 11. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release. IPC-7525 may have alternate design recommendations.
- 12. Board assembly site may have different recommendations for stencil design.

重要なお知らせと免責事項

テキサス・インスツルメンツは、技術データと信頼性データ (データシートを含みます)、設計リソース (リファレンス デザインを含みます)、アプリケーションや設計に関する各種アドバイス、Web ツール、安全性情報、その他のリソースを、欠陥が存在する可能性のある「現状のまま」提供しており、商品性および特定目的に対する適合性の黙示保証、第三者の知的財産権の非侵害保証を含むいかなる保証も、明示的または黙示的にかかわらず拒否します。

これらのリソースは、テキサス・インスツルメンツ製品を使用する設計の経験を積んだ開発者への提供を意図したものです。(1) お客様のアプリケーションに適した テキサス・インスツルメンツ製品の選定、(2) お客様のアプリケーションの設計、検証、試験、(3) お客様のアプリケーションに該当する各種規格や、その他のあらゆる安全性、セキュリティ、規制、または他の要件への確実な適合に関する責任を、お客様のみが単独で負うものとします。

上記の各種リソースは、予告なく変更される可能性があります。これらのリソースは、リソースで説明されている テキサス・インスツルメンツ製品を使用するアプリケーションの開発の目的でのみ、テキサス・インスツルメンツはその使用をお客様に許諾します。これらのリソースに関して、他の目的で複製することや掲載することは禁止されています。テキサス・インスツルメンツや第三者の知的財産権のライセンスが付与されている訳ではありません。お客様は、これらのリソースを自身で使用した結果発生するあらゆる申し立て、損害、費用、損失、責任について、テキサス・インスツルメンツおよびその代理人を完全に補償するものとし、テキサス・インスツルメンツは一切の責任を拒否します。

テキサス・インスツルメンツの製品は、[テキサス・インスツルメンツの販売条件](#)、または [ti.com](https://www.ti.com) やかかる テキサス・インスツルメンツ製品の関連資料などのいずれかを通じて提供する適用可能な条項の下で提供されています。テキサス・インスツルメンツがこれらのリソースを提供することは、適用されるテキサス・インスツルメンツの保証または他の保証の放棄の拡大や変更を意味するものではありません。

お客様がいかなる追加条項または代替条項を提案した場合でも、テキサス・インスツルメンツはそれらに異議を唱え、拒否します。

郵送先住所: Texas Instruments, Post Office Box 655303, Dallas, Texas 75265

Copyright © 2025, Texas Instruments Incorporated

PACKAGING INFORMATION

Orderable part number	Status (1)	Material type (2)	Package Pins	Package qty Carrier	RoHS (3)	Lead finish/ Ball material (4)	MSL rating/ Peak reflow (5)	Op temp (°C)	Part marking (6)
DRV8161DGSR	Active	Production	VSSOP (DGS) 20	5000 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	8161
DRV8162DGSR	Active	Production	VSSOP (DGS) 20	5000 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	8162
DRV8162LDGSR	Active	Production	VSSOP (DGS) 20	5000 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	8162L
PDRV8161DGSR	Active	Preproduction	VSSOP (DGS) 20	3000 LARGE T&R	-	Call TI	Call TI	-40 to 125	
PDRV8162LDGSR	Active	Preproduction	VSSOP (DGS) 20	3000 LARGE T&R	-	Call TI	Call TI	-40 to 125	

⁽¹⁾ **Status:** For more details on status, see our [product life cycle](#).

⁽²⁾ **Material type:** When designated, preproduction parts are prototypes/experimental devices, and are not yet approved or released for full production. Testing and final process, including without limitation quality assurance, reliability performance testing, and/or process qualification, may not yet be complete, and this item is subject to further changes or possible discontinuation. If available for ordering, purchases will be subject to an additional waiver at checkout, and are intended for early internal evaluation purposes only. These items are sold without warranties of any kind.

⁽³⁾ **RoHS values:** Yes, No, RoHS Exempt. See the [TI RoHS Statement](#) for additional information and value definition.

⁽⁴⁾ **Lead finish/Ball material:** Parts may have multiple material finish options. Finish options are separated by a vertical ruled line. Lead finish/Ball material values may wrap to two lines if the finish value exceeds the maximum column width.

⁽⁵⁾ **MSL rating/Peak reflow:** The moisture sensitivity level ratings and peak solder (reflow) temperatures. In the event that a part has multiple moisture sensitivity ratings, only the lowest level per JEDEC standards is shown. Refer to the shipping label for the actual reflow temperature that will be used to mount the part to the printed circuit board.

⁽⁶⁾ **Part marking:** There may be an additional marking, which relates to the logo, the lot trace code information, or the environmental category of the part.

Multiple part markings will be inside parentheses. Only one part marking contained in parentheses and separated by a "-" will appear on a part. If a line is indented then it is a continuation of the previous line and the two combined represent the entire part marking for that device.

Important Information and Disclaimer: The information provided on this page represents TI's knowledge and belief as of the date that it is provided. TI bases its knowledge and belief on information provided by third parties, and makes no representation or warranty as to the accuracy of such information. Efforts are underway to better integrate information from third parties. TI has taken and continues to take reasonable steps to provide representative and accurate information but may not have conducted destructive testing or chemical analysis on incoming materials and chemicals. TI and TI suppliers consider certain information to be proprietary, and thus CAS numbers and other limited information may not be available for release.

In no event shall TI's liability arising out of such information exceed the total purchase price of the TI part(s) at issue in this document sold by TI to Customer on an annual basis.

TAPE AND REEL INFORMATION

QUADRANT ASSIGNMENTS FOR PIN 1 ORIENTATION IN TAPE


*All dimensions are nominal

Device	Package Type	Package Drawing	Pins	SPQ	Reel Diameter (mm)	Reel Width W1 (mm)	A0 (mm)	B0 (mm)	K0 (mm)	P1 (mm)	W (mm)	Pin1 Quadrant
DRV8161DGSR	VSSOP	DGS	20	5000	330.0	16.4	5.4	5.4	1.45	8.0	16.0	Q1
DRV8162DGSR	VSSOP	DGS	20	5000	330.0	16.4	5.4	5.4	1.45	8.0	16.0	Q1
DRV8162LDGSR	VSSOP	DGS	20	5000	330.0	16.4	5.4	5.4	1.45	8.0	16.0	Q1

TAPE AND REEL BOX DIMENSIONS


*All dimensions are nominal

Device	Package Type	Package Drawing	Pins	SPQ	Length (mm)	Width (mm)	Height (mm)
DRV8161DGSR	VSSOP	DGS	20	5000	353.0	353.0	32.0
DRV8162DGSR	VSSOP	DGS	20	5000	353.0	353.0	32.0
DRV8162LDGSR	VSSOP	DGS	20	5000	353.0	353.0	32.0

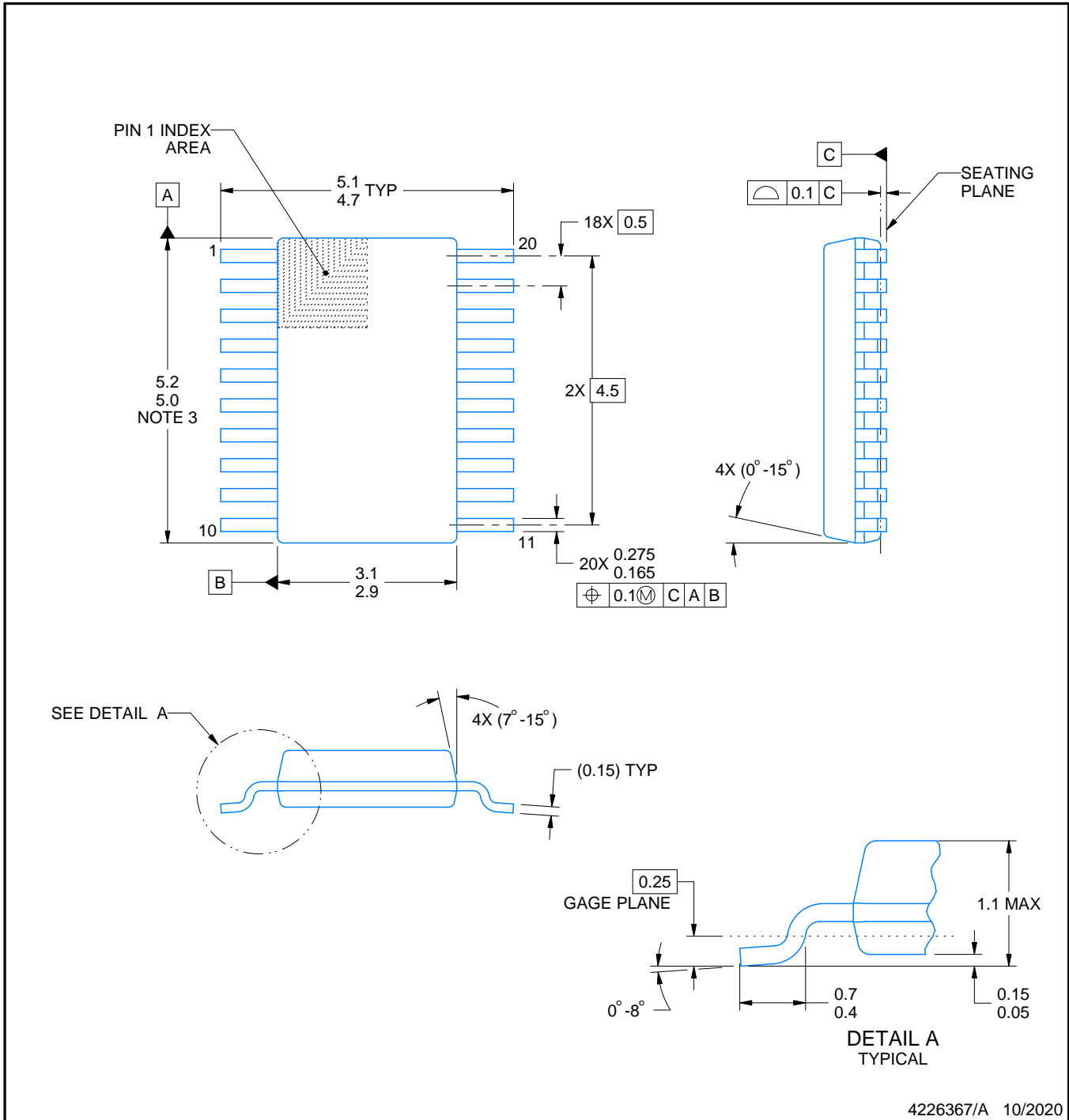
DGS0020A



PACKAGE OUTLINE

VSSOP - 1.1 mm max height

SMALL OUTLINE PACKAGE



4226367/A 10/2020

NOTES:

PowerPAD is a trademark of Texas Instruments.

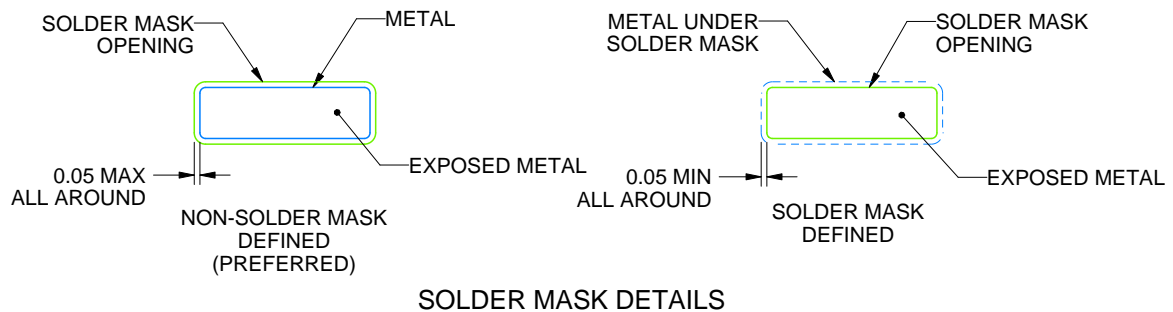
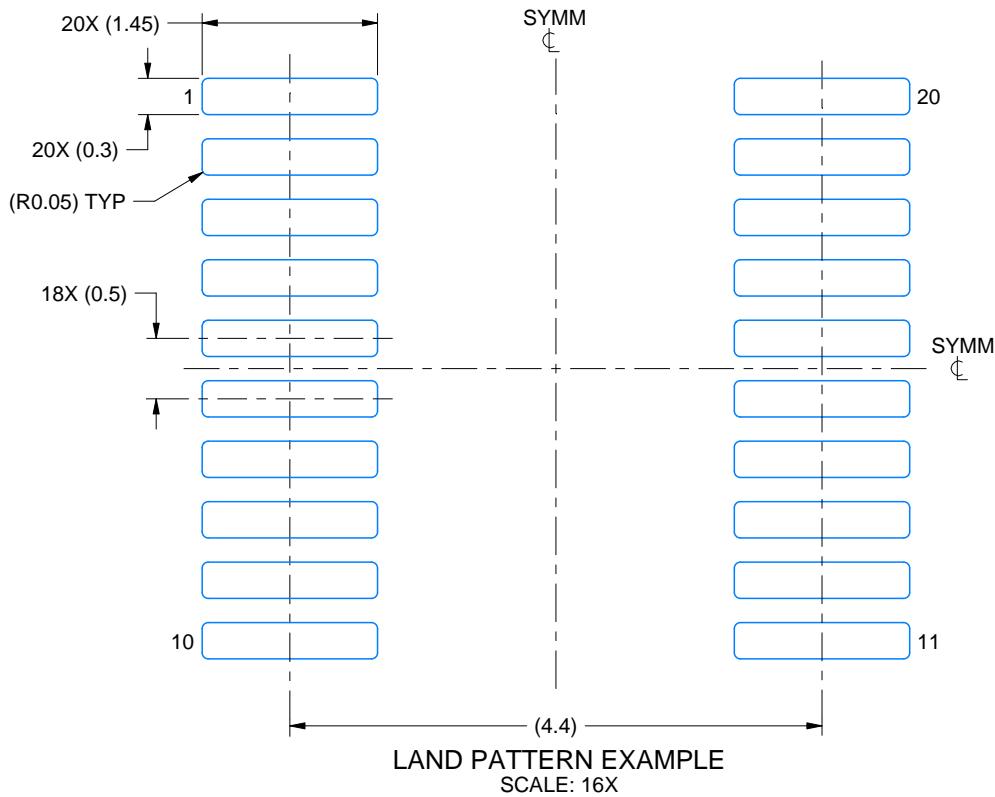
1. All linear dimensions are in millimeters. Any dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.
3. This dimension does not include mold flash, protrusions, or gate burrs. Mold flash, protrusions, or gate burrs shall not exceed 0.15 mm per side.
4. No JEDEC registration as of September 2020.
5. Features may differ or may not be present.

EXAMPLE BOARD LAYOUT

DGS0020A

VSSOP - 1.1 mm max height

SMALL OUTLINE PACKAGE



4226367/A 10/2020

NOTES: (continued)

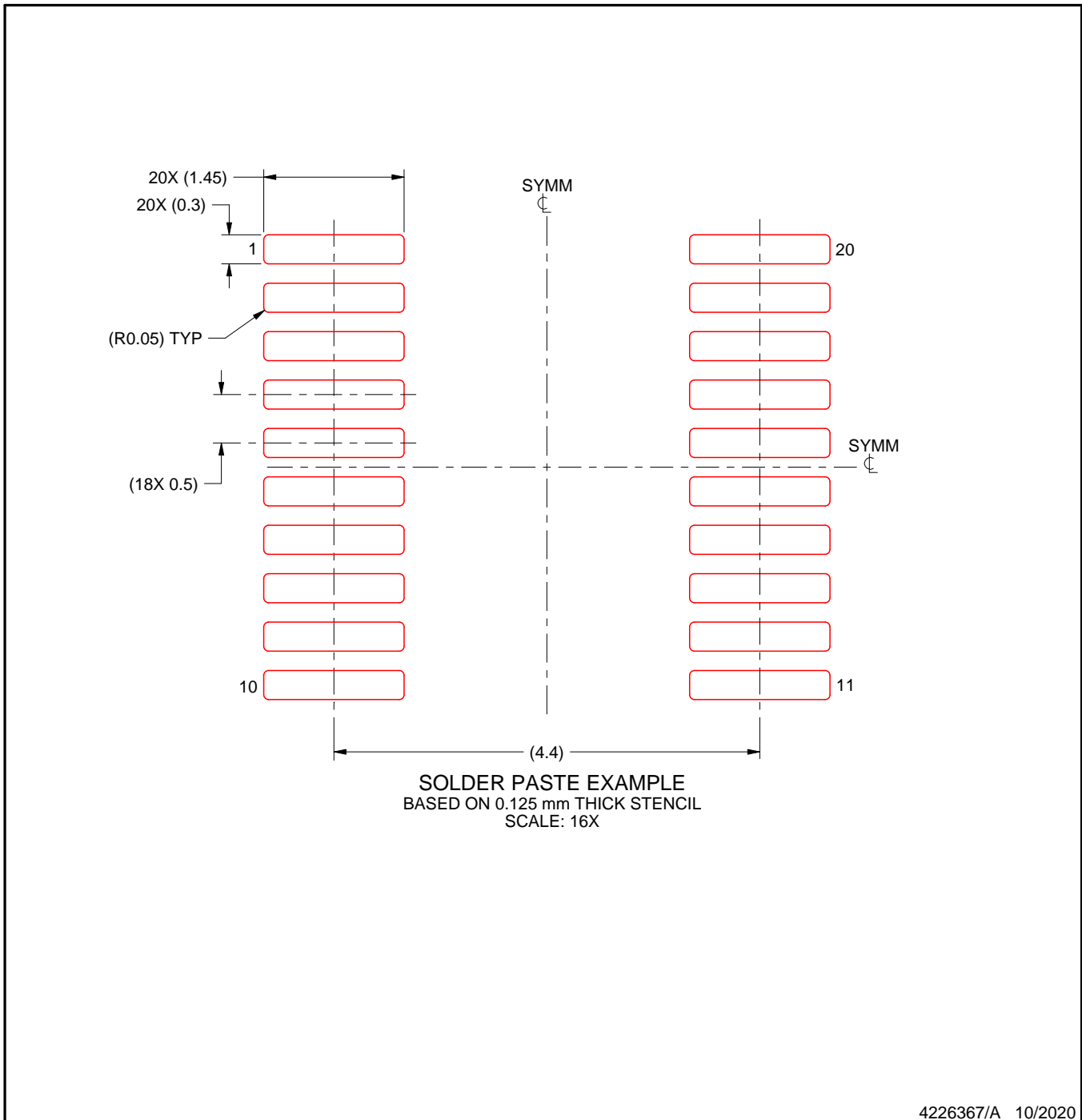
6. Publication IPC-7351 may have alternate designs.
7. Solder mask tolerances between and around signal pads can vary based on board fabrication site.
8. This package is designed to be soldered to a thermal pad on the board. For more information, see Texas Instruments literature numbers SLMA002 (www.ti.com/lit/slma002) and SLMA004 (www.ti.com/lit/slma004).
9. Size of metal pad may vary due to creepage requirement.
10. Vias are optional depending on application, refer to device data sheet. It is recommended that vias under paste be filled, plugged or tented.

EXAMPLE STENCIL DESIGN

DGS0020A

VSSOP - 1.1 mm max height

SMALL OUTLINE PACKAGE



NOTES: (continued)

11. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release. IPC-7525 may have alternate design recommendations.
12. Board assembly site may have different recommendations for stencil design.

重要なお知らせと免責事項

テキサス・インスツルメンツは、技術データと信頼性データ(データシートを含みます)、設計リソース(リファレンス デザインを含みます)、アプリケーションや設計に関する各種アドバイス、Web ツール、安全性情報、その他のリソースを、欠陥が存在する可能性のある「現状のまま」提供しており、商品性および特定目的に対する適合性の黙示保証、第三者の知的財産権の非侵害保証を含むいかなる保証も、明示的または黙示的にかかわらず拒否します。

これらのリソースは、テキサス・インスツルメンツ製品を使用する設計の経験を積んだ開発者への提供を意図したものです。(1) お客様のアプリケーションに適したテキサス・インスツルメンツ製品の選定、(2) お客様のアプリケーションの設計、検証、試験、(3) お客様のアプリケーションに該当する各種規格や、その他のあらゆる安全性、セキュリティ、規制、または他の要件への確実な適合に関する責任を、お客様のみが単独で負うものとします。

上記の各種リソースは、予告なく変更される可能性があります。これらのリソースは、リソースで説明されているテキサス・インスツルメンツ製品を使用するアプリケーションの開発の目的でのみ、テキサス・インスツルメンツはその使用をお客様に許諾します。これらのリソースに関して、他の目的で複製することや掲載することは禁止されています。テキサス・インスツルメンツや第三者の知的財産権のライセンスが付与されている訳ではありません。お客様は、これらのリソースを自身で使用した結果発生するあらゆる申し立て、損害、費用、損失、責任について、テキサス・インスツルメンツおよびその代理人を完全に補償するものとし、テキサス・インスツルメンツは一切の責任を拒否します。

テキサス・インスツルメンツの製品は、[テキサス・インスツルメンツの販売条件](#)、または [ti.com](https://www.ti.com) やかかるテキサス・インスツルメンツ製品の関連資料などのいずれかを通じて提供する適用可能な条項の下で提供されています。テキサス・インスツルメンツがこれらのリソースを提供することは、適用されるテキサス・インスツルメンツの保証または他の保証の放棄の拡大や変更を意味するものではありません。

お客様がいかなる追加条項または代替条項を提案した場合でも、テキサス・インスツルメンツはそれらに異議を唱え、拒否します。

郵送先住所：Texas Instruments, Post Office Box 655303, Dallas, Texas 75265
Copyright © 2025, Texas Instruments Incorporated